

**ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
К ЖУРНАЛУ «ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ»**

Том 25, 1991 год

- Абакумов В. Н., Пахомов А. А., Ясиевич И. Н. Разогрев локальных колебаний при безызлучательной рекомбинации и рекомбинационно-стимулированные явления в полупроводниках (обзор). 9, 1489
- Абдинов А. Ш., см. Джафарова С. З. 6, 983
- Абдукаримова Х. Р., см. Касымова Р. С. 9, 1566
- Абдулгаббов М. Ш., Байков Ю. М., Жданович Н. С., Косарев А. И., Цветков В. Ф. Термическая эффузия водорода в пленках α -C:H, полученных методом плазмохимического осаждения. 1, 77
- Абдуллаев А. А., Гаджиев А. З. Некоторые особенности диффузии и дрейфа неравновесных носителей в CdCr_2Se_4 . 1, 30
- Абдуллаев М. А., см. Кохановский С. И. 3, 493
- Абдуллаев М. А., см. Магомедов М.-Р. А. 6, 1088
- Абдулли Х. А., Мукашев Б. Н., Тамендаров М. Ф. Исследование рекомбинационно-ускоренного отжига радиационных дефектов в кремнии. 4, 684
- Абдулли Х. А., см. Чихрай Е. В. 4, 751
- Абдурахманов К. П., Куликов Г. С., Лебедев А. А., Утамурадова Ш. Б., Юсупова Ш. А. Исследование поведения примесей марганца и никеля при диффузионном легировании кремния. 6, 1075
- Абрамов В. В., Брандт Н. Б., Кульбачинский В. А., Тимофеев А. Б., Ульяшин Ф. Г., Шлопак Н. В., Горольчук И. Г. Низкотемпературная электропроводность сильно легированного Si. 3, 513
- Абрамов В. С., Акимченко И. П., Дравин В. А., Дымова Н. Н., Краснолещев В. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. Совместная имплантация электрически активной и изовалентной примесей. 8, 1355
- Абуталыбов Г. И., см. Джафарова С. З. 6, 983
- Аверкиев Н. С., Аширов Т. К., Гуткин А. А., Осипов Е. Б., Седов В. Е., Цацульников А. Ф. Стабилизация ориентации ян-теллеровских искажений акцептора Au_{Ga}^0 в GaAs при низких температурах и переориентация центра в процессе рекомбинации. 11, 1967
- Аверкиев Н. С., Гуткин А. А., Осипов Е. Б., Рещиков М. А., Седов В. Е., Сосновский В. Р. Оптическая анизотропия центра, вызывающего полосу фотолюминесценции с максимумом вблизи 1.18 эВ в GaAs:Te. I. Поляризованная фотолюминесценция. 1, 50
- Аверкиев Н. С., Гуткин А. А., Осипов Е. Б., Рещиков М. А., Седов В. Е., Сосновский В. Р. Оптическая анизотропия центра, вызывающего полосу фотолюминесценции с максимумом вблизи 1.18 эВ в GaAs:Te. II. Влияние одноосного давления на фотолюминесценцию центра. 1, 58
- Аверкиев Н. С., Гуткин А. А., Осипов Е. Б., Седов В. Е., Смирнов Н. А., Цацульников А. Ф. Влияние смешивания электронных состояний электронно-колебательным взаимодействием на строение и пьезоспектроскопические свойства ян-теллеровских акцепторов в GaAs. 11, 1976
- Авериев Н. С., Кушкимбаева Б. Ш., Кютт Р. Н., Матвеев Б. А., Стусь Н. М., Талалакин Г. Н., Чайкина Е. И. Поляризация фотолюминесценции с поверхности гетероструктуры $\text{Al}_{\text{In}}\text{V}^{\text{V}}$ с профилированной подложкой. 1, 12
- Аверьянов В. Л., см. Сарсембинов Ш. Ш. 3, 564
- Авруцкий И. А., Сыгучов В. А., Усиевич Б. А. Расчет параметров экситона в напряженных КЯ структурах на основе $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}/\text{GaAs}$. 10, 1787
- Агаев Н. А., см. Аждаров Г. Х. 4, 760
- Агапов Б. Л., см. Сысоев Б. И. 4, 699
- Адамсон П. В. О роли фотоактивного поглощения собственной люминесценции в полосковых многопроходных гетероструктурах. 4, 608
- Адилов К. А. Фотохимическая перестройка глубоких центров в кремнии: распад донорно-акцепторных пар. 7, 1157
- Аждаров Г. Х., Агаев Н. А., Кязим-заде Р. А. Подвижность электронов в твердых растворах германий-кремний при рассеянии на фононах и беспорядках сплава. 4, 760
- Азаренков Н. А., Остриков К. Н.

- Влияние разогрева электронов на распространение магнитоплазменных поверхностных волн в структуре полупроводник—металл. 8, 1344
- А и т о в Р. Д., Р ж е в к и н К. С., Т к а ч е в С. Н. Нелинейность вольт-амперной характеристики полупроводников при слабых электрических полях. 5, 904
- А й в а з о в А. А., Б у д а г я н Б. Г., П р и х о д ь к о Е. Л., С а з о н о в А. Ю. Термическая стабильность пленок α -Si : H, легированных азотом. 10, 1802
- А й в а з о в А. А., Б у д а г я н Б. Г., С т а н о в о в О. Н. Фотоэлектрические свойства α -Si : H, легированного азотом. 10, 1808
- А й в а з о в А. А., Б у д а г я н В. Г., С т р я х и л е в Д. А. Оптические свойства пленок α -Si : H, легированных азотом, и дефектные состояния в них. 11, 2040
- А й д а е в Ф. Ш., см. Аскеров И. М. 11, 2042
- А к и м о в А. В., Ж и л я е в Ю. В., К р и в о л а п ч у к В. В., П о л е т а е в Н. К., Ш о ф м а н В. Г. Экспериментальное наблюдение дырок в n -GaAs, высвободившихся в результате оже-распада локализованных состояний. 4, 713
- А к и м о в А. В., Ш о ф м а н В. Г. Рекомбинация горячих электронов с дырками на центрах прилипания в эпитаксиальном n -GaAs. 7, 1133
- А к и м о в А. В., Ш о ф м а н В. Г. Воздействие излучения 10.6 мкм на краевую люминесценцию эпитаксиального n -GaAs. 9, 1593
- А к и м о в Б. А., Б е л о к о н ь С. А., Д а ш е в с к и й З. М., Е г о р о в К. Н., Л а к с е н к о в В. М., Н и к о р и ч А. В., Р я б о в а Л. И. Энергетический спектр и фотопроводимость твердых растворов $Pb_{1-x}Mn_xTe(Ga)$. 2, 250
- А к и м о в Б. А., К о р о б е й н и к о в а Е. Н., Р я б о в а Л. И., Т а м м М. Е. Влияние Tm на свойства теллурида свинца. 2, 342
- А к и м ч е н к о И. П., см. Абрамов В. С. 8, 1355
- А к и м ч е н к о И. П., см. Заварицкая Э. И. 7, 1263
- А л е к с а н д р о в Л. Н., Б о н д а р е в а Т. В., К а ч у р и н Г. А., Т ы с ч е н к о И. Е. Численное моделирование диффузии бора и фосфора в кремнии при высокотемпературной ионной имплантации. 2, 227
- А л е ш к и н В. Я., Д е м и д о в Е. В., З в о н к о в Б. Н., М у р е л ь А. В., Р о м а н о в Ю. А. Исследование квантовых ям C—V-методом. 6, 1047
- А л е ш к о Ю. А., В о д о п ь я н о в Л. К. Возникновение упругих напряжений за границей аморфизированной области, созданной в GaAs ионной имплантацией. 7, 1259
- А л и е в Б. Д., см. Нифтиев Г. М. 4, 704
- А л и е в И. М., см. Алиев М. И. 11, 2054
- А л и е в М. И., Х а л и л о в Х. А., Р а ш и д о в а Ш. Ш., А л и е в И. М. Влияние разупорядоченности на глубокие центры в кристаллах.* 11, 2054
- А л и м и е в В. Н., Г у р а л ь н и к И. Р. Трехволновое акустоэлектронное взаимодействие с участием волн пространственной перезарядки ловушек. 12, 2105
- А л а х в е р д и е в А. М., Б а к и р о в М. Я., М а д а т о в Р. С., К а б у л о в И. А. Влияние радиации на фотоэлектрические параметры фотопреобразователей на основе Ge—Si. 1, 177
- А л ф ё р о в Ж. И. Джон Бардин. Памяти великого физика современности. 3, 572
- А л ь - Б а к к у р Ф., Д и д ы к А. Ю., К о з л о в И. П., О д ж а е в В. Б., П е т р о в В. В., П р о с о л о в и ч В. С., С о х а ц к и й А. С. Особенности дефектообразования в кремнии при высокоэнергетичной имплантации бора. 10, 1841
- А м а л ь с к а я Р. М., Г а м а р ц Е. М., С а ф а р о в В. И. Измерение эффективного времени жизни носителей заряда в полупроводниках. 3, 529
- А м и р х а н о в а Дж. Х., см. Магомедов М.-Р. А. 6, 1088
- А н д а с п а е в а А. А., Б а р а н о в А. Н., Г е л ь м о н т Б. Л., Д ж у р т а н о в Б. Е., З е г р я Г. Г., И м е н к о в А. Н., Я к о в л е в Ю. Н., Я с т р е б о в С. Г. Исследование температурной зависимости пороговой плотности тока ДГС лазеров на основе GaInAsSb. 3, 394
- А н д е р с е н Г. Ю., Г у с е в О. К., З а и т о в Ф. А., К и р и е н к о В. П., Я р ж е м б и ц к и й В. Б. Влияние условий измерений на аномальный эффект Холла в p -InAs. 11, 1999
- А н д р е е в А. Н., см. Аникин М. М. 2, 328
- А н д р е е в Б. А., К о з л о в Е. Б., Л и ф ш и ц Т. М. О ширине линий примесных оптических переходов в абсорбционных и фототермоионизационных спектрах. 5, 880
- А н д р е е в И. А., М и х а й л о в а М. П., М е л ь н и к о в С. В., С м о р ч к о в а Ю. П., Я к о в л е в Ю. П. Лавинное умножение и коэффициенты ионизации в GaInAsSb. 8, 1429
- А н д р е е в С. П., А с т в а ц а т у р ь я н Е. Р., Г о л о в и н А. В., К у д р я ш о в Н. А., К у ч е р е н к о С. С., П о л у н и н В. А., Ч и ч е р к о в А. В. Ионизационная реакция p - l -структур ИМС при больших интенсивностях ионизирующего излучения. 1, 128
- А н д р е е в а В. Д., Д ж у м а м у х а м б е т о в Н. Г., Д м и т р и е в А. Г. Термический отжиг кристаллов GaAs, модифицированных лазерным излучением. 9, 1624
- А н д р и а н о в А. В. Исследование эпитаксиальных твердых растворов $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y$ методом комбинационного рассеяния света. 6, 1086
- А н д р и е в с к и й В. Ф., И в а н ю к о в и ч В. А., К а р а с ь В. И., Л о м а к о В. М. Особенности емкостной спектроскопии глубоких центров в диодах Шоттки. 2, 222

* Статьи, отмеченные звездочкой, депонированы в ЦНИИ «Электроника».

- Андрюшко А. И., Пенцов А. В., Салихов Х. М., Слободчиков С. В. Производство R_0A в InAs $p-n$ -переходах. 10, 1686
- Аникин М. М., Андреев А. Н., Лебедев А. А., Пятко С. Н., Растегаева М. Г., Савкина Н. С., Стрельчук А. М., Сыркин А. Л., Челнок В. Е. Высокотемпературный диод Шоттки Au—SiC-6H. 2, 328
- Аникин М. М., Зубрилов А. С., Лебедев А. А., Стрельчук А. П., Черенков А. Е. Рекомбинационные процессы в 6H-SiC $p-n$ -структурах и влияние на них глубоких центров. 3, 479
- Антоненко Р. С., см. Гроза А. А. 10, 1821
- Антонова И. В., Шаймеев С. С. Температурная зависимость амплитуды пика DLTS в кремнии с глубокими центрами. 5, 847
- Антюшин В. Ф., см. Сысоев Б. И. 4, 708
- Арлаускас К., см. Голикова О. А. 3, 551
- Аронов Д. А., Валиев Б. Х., Маматкулов Б. Р. Малосигнальные характеристики структур из «чистых» полупроводников с нейнектрирующими контактами в условиях полной эксклюзии носителей тока. 12, 2228
- Аронов Д. А., Маматкулов Б. Р. Расширение диапазона температур применной проводимости «чистого» германия с помощью эффекта эксклюзии. 7, 1129
- Артамонов В. В., Бачериков Ю. Ю., Лашкевич Е. Г., Нечипорук Б. Д., Садофьев Ю. Г. Механические напряжения в гетероэпитаксиальном GaAs, выращенном на Si-подложке. 4, 670
- Артамонов В. В., Валах М. Я., Киршт Ф., Клыч Н. И., Литовченко В. Г., Нечипорук Б. Д., Романюк Б. Н. Исследование пространственного распределения дефектов и механических напряжений в кремнии, имплантированном ионами углерода. 10, 1704
- Арутюнян В. М. Рецензия на книгу Плескова Ю. В. «Фотоэлектрохимическое преобразование солнечной энергии». 4, 767
- Арушанов Э. К., см. Кульбачинский В. А. 12, 2201
- Архипов В. И., Емельянова Е. В. «Вспышечная» кинетика фотостимулированного оптического поглощения в стеклообразных полупроводниках. 10, 1792
- Архипов В. И., Емельянова Е. В. Отклонения от закона Бугера при распространении светового сигнала в волокнах из халькогенидных стекол. 12, 2222
- Асеев А. Л., Денисенко С. Г., Федина Л. И. Влияние процессов аннигиляции точечных дефектов на рост сплюснений междоузельных атомов при облучении кристаллов Si и Ge электронами в высоковольтном электронном микроскопе. 4, 582
- Аскеров И. М., Айдаев Ф. Ш., Асланов Г. К., Мастеров В. Ф., Тагиев Б. Г. Люминесценция примесных центров Eu и Mn в монокристаллах Ga₂S₃(Se₃). 11, 2042
- Асланов Г. К., см. Аскеров И. М. 11, 2042
- Аствацатурьян Е. Р., см. Андреев С. П. 1, 128
- Астрова Е. В., Бобровникова И. А., Вилисова М. Д., Ивлева О. М., Лаврентьева Л. Г., Лебедев А. А., Тетеркина И. В., Чалдышев В. В., Чернов Н. А., Шмарцев Ю. В. Влияние изовалентного легирования индия на свойства эпитаксиальных слоев арсенида галлия, выращенного из газовой фазы. 5, 898
- Атаев Ж., Васильев В. А., Волков А. С., Кумеков М. Е., Теруков Е. И., Шведков И. В. Фотоэлектрические свойства пленок α -Si:H и структур на их основе в УФ области спектра. 8, 1350
- Атакулов Ш. Б., Онаркулов К. Э., Рахманкулов М. Х. Механизм термической деградации фоточувствительных слоев PbS. 4, 633
- Ахмедов А. А., см. Кязым-заде А. Г. 8, 1392
- Аширов Т. К., см. Аверкиев Н. С. 11, 1967
- Ашмонтас С., Валушис Г., Либерис Ю., Субачюс Л. Охлаждение электронов и шумы в греющих электрических полях. 11, 1957
- Бабаходжаев У. С., см. Голикова О. А. 1, 102
- Бабаходжаев У. С., см. Голикова О. А. 3, 551
- Бабенцов В. Н., Горбань С. И., Жовнир Г. И., Рашковецкий Л. В. Поведение остаточной примеси Li в высокоомном теллуриде кадмия при кратковременном отжиге. 4, 756
- Бабенцов В. Н., Горбань С. И., Городецкий И. Я., Корсунская Н. Е., Раренко И. М., Шейнкман М. К. Влияние ультразвуковой обработки на экситонную и примесную люминесценцию CdTe. 7, 1243
- Бабичкий Ю. М., Васильева М. В., Гринштейн П. М., Ильин М. А., Ремизов О. А. О влиянии термической предистории на образование кислородных доноров в кремнии. 5, 838
- Бабичкий Ю. М., Васильева М. В., Гринштейн П. М. Влияние предварительного низкотемпературного отжига на образование высокотемпературных доноров в монокристаллах кремния. 10, 1824
- Бабич В. М., Баран Н. П., Бугай А. А., Зотов К. И., Ковальчук В. Б., Максименко В. М. ЭПР-акцепторных центров, образующихся в процессе длительных отжигов кремния при 550 °С. 1, 118
- Бабянкас Э., Бальчюнас В., Балявичюс С., Ченис А., Шикторов Н., Ясутис В. Кинетика наносекундной электрической «формовки» переключающих элементов на основе некристаллических пленок Ge_xTe_{1-x}. 5, 823
- Багдасарян Р. И., см. Варданян Г. А. 2, 295

- Баграев Н. Т., Клячкин Л. Е., Маляренко А. М., Суханов В. Л. Фрактально-диффузионные $p-n$ -переходы в кремнии. 4, 644
- Баграев Н. Т., Клячкин Л. Е., Суханов В. Л. Туннельные эффекты в двумерной кремниевой транзисторной структуре. 9, 1613
- Баев А. С., см. Домашевская Э. П. 5, 893
- Баженов Н. Л., Гасанов С. И., Иванов - Омский В. И., Миرونков К. Е., Мынбаев К. Д. Темновые токи в $p-n$ -переходах, созданных ионно-лучевым травлением на кристаллах $Cd_xHg_{1-x}Te$. 12, 2196
- Баженов Н. Л., Иванов - Омский В. И., Ижнин А. И., Смирнов В. А. Квантовый выход фотолуминесценции в твердых растворах $Cd_xHg_{1-x}Te$ ($0.4 \leq x \leq 0.74$). 6, 1103
- Байдусь Н. В., см. Бедный Б. И. 8, 1450
- Байков Ю. М., см. Абдулвагабов М. Ш. 1, 77
- Бакиров М. Я., см. Аллавердиев А. М. 1, 177
- Балландович В. С. Акцептор скандий в $6H-SiC$. 2, 287
- Балмуш И. И., см. Касиян А. И. 4, 689
- Балтрамеюнас Р., Велецкас Д., Нятикшис В., Пятраускас М., Скайстис Э. Изменение оптических свойств кристаллов кремния в пико-секундном временном диапазоне. 4, 736
- Балтрамеюнас Р., Гульбинас В., Екимов А. И., Кудрявцев И. А., Пакальнис С., Тамулайтис Г., Чепик Д. И. Быстрое переключение пропускания света в стеклах, активированных микрокристаллами CdS . 2, 271
- Бальчюнас В., см. Бабянскас Э. 5, 823
- Бальчюнас В., Балявичюс С., Ченис А., Шикторов Н. Аномальная зависимость времени включения от перенапряжения в сверхбыстродействующих переключателях на основе аморфных полупроводников. 5, 818
- Балявичюс С., см. Бабянскас Э. 5, 823
- Балявичюс С., см. Бальчюнас В. 5, 818
- Банайтис А., см. Пятраускас М. 2, 344
- Баран Н. П., см. Бабиц В. М. 1, 118
- Баранов А. Н., Васильев В. А., Копылов А. А., Шерстнев В. В. Оптическое отражение и определение характеристик эпитаксиальных структур $InAs_{1-x-y}Sb_xP_y/InAs$. 1, 99
- Баранов А. Н., см. Андаспаева А. А. 3, 394
- Баранов И. А., Кучинский П. В., Ломако В. М., Петрунин А. П., Цепелевич С. О., Шахлевич Л. Н. Дефектообразование в кремнии, облученном частицами с массой ~ 100 а. е. м. и энергией до 100 МэВ. II. Изменение рекомбинационных свойств. 1, 73
- Баранский П. И., Беляев А. Е., Горбатюк И. Н., Комирченко С. М., Раренко И. М., Шевченко Н. В. Рекомбинация в $Hg_{1-x-y}Cd_xMn_yTe$ ($x \approx 0.28 - 0.35$, $y \approx 0.01 - 0.02$). 7, 1183
- Баранюк В. Е., Махний В. П. Электрические и фотоэлектрические свойства гетеропереходов сульфид-теллурид кадмия. 2, 217
- Барышев Н. С., см. Трифопова М. М. 6, 1014
- Басаласв Ю. М., Полыгалов Ю. И., Поплавной А. С. Температурная зависимость энергетических уровней в полупроводниковых соединениях $A^{IV}B^{IV}C_2V_6$. 5, 952
- Бахадырханов М. К., Миркамиллова М. С., Шустров В. А. Определение профиля концентрации марганца и никеля, имплантированных в кремний. 11, 1952.
- Бахадырханов М. К., Хамидов А., Илиев Н. М., Парманкулов И. П. Возбуждение рекомбинационных волн в кремнии, компенсированном марганцем при одноосной упругой деформации. 10, 1731
- Бачеригов Ю. Ю., см. Артамонов В. В. 4, 670
- Бегенин Н. Г. Деформационная зависимость коэффициента поглощения света в ферромагнитных полупроводниках $CdCr_2Se_4$ и $HgCr_2Se_4$ вблизи края фундаментальной полосы. 9, 1661
- Бедельбаева Г. Е., Колобов А. В., Любин В. М. Поперечная диффузия серебра в пленках халькогенидных стеклообразных полупроводников. 2, 197
- Бедный Б. И., Карпович И. А., Байдусь Н. В., Болдыревский П. Б., Степанов А. С., Федосеева Н. В. Фотопроводимость и конденсаторная фотоэде в δ -легированных слоях $GaAs$. 8, 1450
- Безрядин Н. Н., см. Сысоев Б. И. 4, 699
- Бейсюк П. П., Савицкий А. В., Илащук М. И., Руснак Н. И., Власков В. И., Парфенюк Ф. А. Рваносные свойства твердых растворов $Cd_{1-x}Mg_xTe$. 6, 961
- Бекетов Г. В., см. Беляев А. Е. 7, 1164
- Белов А. Г., см. Белогорохов А. И. 7, 1196
- Белогорохов А. И., Белогорохова Л. И., Белов А. Г., Рашевская Е. П. Плазменный резонанс свободных носителей заряда и оценка некоторых параметров зонной структуры материала $Cd_xHg_{1-x}Te$. 7, 1196
- Белогорохов А. И., см. Соловьева Е. В. 6, 965
- Белогорохова Л. И., см. Белогорохов А. И. 7, 1196
- Белоконов С. А., см. Акимов Б. А. 2, 250
- Белокорова И. Н., см. Семенюк Ю. А. 9, 1553
- Белотелов С. В., Иванов - Омский В. И., Ижнин А. И., Смирнов В. А. Луминесценция имплантированных слоев $Cd_{0.38}Hg_{0.62}Te$ и диодных структур на их основе. 6, 1058
- Белявский В. И., Капустин Ю. А., Свиридов В. В. Подпороговое дефектообразование при мощной импульсной фотонной обработке кремния. 7, 1204

- Бел яев А. Д., Зв ягин И. П. К теори рекомбинации в аморфных полупроводниках с квазинепрерывным спектром локализованных состояний. 1, 35
- Бел яев А. Е., Бекетов Г. В., Гор одничий О. П., Комир енко С. М., Мух а Л. А. Влияние пассивирующих покрытий на электрофизические свойства кристаллов (Cd, Hg)Te. 7, 1164
- Бел яев А. Е., см. Баранский П. И. 7, 1183
- Бел яков Л. В., Сресели О. М. Поверхностные электромагнитные волны и фотоприемники (обзор). 8, 1281
- Бендюгов В. Е., см. Спириин А. И. 1, 173
- Бер ишев И. Э., см. Гарбузов Д. З. 8, 1414
- Бер ковиц В. Л., Бессолов В. Н., Львова Т. В., Новиков Е. Б., Сафаров В. И., Хасиева Р. В., Паренков Б. В. Потенциальные барьеры на поверхности n - и p -GaAs (100): кинетика движения поверхностного уровня Ферми при химической обработке. 8, 1406
- Бер ковиц В. Л., Иванцов Л. Ф., Макаренко И. В., Львова Т. В., Хасиева Р. В., Сафаров В. И. Исследование в сканирующем туннельном микроскопе поверхности арсенида галлия, пассивированной в водном растворе Na_2S . 3, 379
- Бессолов В. Н., см. Берковиц В. Л. 8, 1406
- Бланк А. Ю., Зинovieв Н. Н., Иванов Л. П., Ковалев Д. И., Ярошецкий И. Д. Экситонная рекомбинация в GaAs, индуцируемая неравновесными акустическими фононами. 1, 67
- Бобр икова О. В., Обрехт М. С., Стась В. Ф. Зарядовые состояния первичных радиационных дефектов и процессы дефектообразования в области пространственного заряда кремниевых диодных структур. 5, 828
- Бобровникова И. А., см. Астрова Е. В. 5, 898
- Бог дапов Е. В. Эффект Сасаки-Шибуй в многодолинных узкощелевых полупроводниках $\text{Vn}_1-x\text{Sbn}_x$. 11, 2028
- Бого боийий В. В., см. Иванов-Омский В. В. 8, 1423
- Божевольнов В. Б., см. Перепелкин А. Д. 1, 156
- Божевольнов В. Б., см. Яфясов А. М. 8, 1339
- Бой ко И. И., Шик А. Я. Охлаждение двумерного электронного газа затвором МДП структуры. 6, 1094
- Бой ков Ю. А., Данилов В. А., Ку саинов О. М., Кутасов В. А. Зависимость анизотропии термоэдс пленок PbTe от проводимости приповерхностного слоя. 7, 1246
- Болдыревский П. Б., см. Бедный Б. И. 8, 1450
- Боло тов В. В., Стучинский В. А. Формирование распределений E -центров на границе областей пространственного заряда при отжиге облученных диодов Шоттки. 4, 723
- Боло тов В. В., Стучинский В. А. Накопление вакансионных и междоузельных дефектов в областях пространственного заряда диодов Шоттки Au-n-Si . 12, 2168
- Бон дарева Т. В., см. Александров Л. Н. 2, 227
- Бор ани И., см. Верибкая 5, 852
- Бор блик В. Л., Грибников З. С., Маркевич Б. П. Теория эффекта в туннельно-резонансной гетероструктуре с селективным рассеянием. 8, 1302
- Бор ковская О. Ю., Дмитрук Н. Л., Мищук О. Н. Фоточувствительность барьеров Шоттки Au-GaAs с микрорельефной поверхностью (область собственного поглощения света). 3, 487
- Бортнянский А. Л., см. Чапланов А. М. 3, 417
- Бочкарева Н. И. Емкостная спектроскопия германия с ростовыми дислокациями. 3, 537
- Брандт Н. Б., см. Абрамов В. В. 3, 513
- Бреслер М. С., Гусев О. Б., Михайлова М. П., Шерстнев В. В., Яковлев Ю. П., Ясиевич И. Н. Интерфейсная люминесценция, обусловленная надбарьерным отражением, в изоэпитонной гетероструктуре p -InAs/ p -InAsP/Sb. 2, 298
- Бродовой А. В., см. Лашкарев Г. В. 5, 950
- Бродовой В. А., Воскобойников А. М., Лысенко А. Е., Нелуп В. А. Акустическая эмиссия биполярных транзисторов в импульсном режиме. 4, 624
- Брунков И. П., Гайбуллаев С., Кошкин С. Г., Никитин В. Г., Папенцев М. И., Соболев М. М. Дефекты с глубокими уровнями в GaAs, выращенном из раствора-расплава Ga-VI. 2, 338
- Бугай А. А., см. Бабич В. М. 1, 118
- Будагян Б. Г., см. Айвазов А. А. 10, 1802
- Будагян Б. Г., см. Айвазов А. А. 10, 1808
- Будагян В. Г., см. Айвазов А. А. 11, 2040
- Буданов А. В., см. Сысоев Б. И. 4, 699
- Будулак В. И., см. Птащенко А. А. 6, 1018
- Бузанова Е. В., Ветров А. П., Кузнецов Ю. М., Левандовский В. Г., Панасюк В. М., Попова Г. Д. Физическое моделирование и экспериментальное исследование особенностей токопереноса в структурах металл- p^+ - n -полупроводник с глубокими уровнями. 7, 1121
- Булах Б. М., Джумаев Б. Р., Корсунская Н. Е., Кулиш Н. Р., Лисица М. П., Малыш Н. И., Сергеев С. О., Шейнкман Н. К. Влияние отжига в парах собственных компонентов на поглощение света в области урбаховского края CdSe . 11, 194
- Буреев А. В., см. Георгобияни А. Н. 3, 390
- Бурка А., см. Сырбу Н. Н. 6, 1067
- Буянов А. В., Лютович К. Л., Пека Г. П., Ткаченко В. Н. Использование метода отраженных электронов в электронно-зондовом профиле

- ровании гетероструктур на основе соединений $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}$. 10, 1711
- Бычковский Д. Н., Константинов О. В., Панахов М. М. Теория «могтовского» плато на вольт-фарадной характеристике диода Шоттки с гетеропереходом. 4, 660
- Бычковский Д. Н., Константинов О. В., Панахов М. М. Вольт-фарадная характеристика $m-s$ -структур с изотипным гетеропереходом. 11, 1889
- Вавилов В. С., Водаков Ю. А., Иванов А. И., Мохов Е. Н., Роенков А. Д., Чукичев М. В., Веренчикова Р. Г. Люминесценция эпитаксиальных слоев $6H\text{-SiC}$, облученных быстрыми электронами. 4, 762
- Вавилов В. С., см. Заварицкая Э. И. 7, 1263
- Вавилов С. Е., см. Чайка Г. Е. 2, 336
- Вайткус Ю., см. Томашюнас Р. 6, 1034
- Вакуленко О. В., Супруненко В. Н., Рыжиков В. Д. Температурная зависимость интенсивности примесной люминесценции в полупроводниках с амфотерными центрами рекомбинации. 6, 1053
- Валах М. Я., см. Артамонов В. В. 10, 1704
- Валиев Б. Х., см. Аронов Д. А. 12, 2228
- Валушис Г., см. Ашмонтас С. 11, 1957
- Ван Си-фу, см. Син Сюй. 4, 577
- Вардамян Г. А., Багдасарян Р. И., Петросян П. Г., Григорян Л. Н. Получение тонких пленок CdS лазерным распылением. 2, 295
- Васильев А. Э., Ильин Н. П., Мастеров В. Ф. Структура волновых функций примесных центров переходных элементов в соединениях $\text{Al}_x\text{In}_{1-x}\text{V}$. 2, 203
- Васильев А. Э., см. Ильин Н. П. 2, 185
- Васильев В. А., Дышловенко П. Е., Копылов А. А., Лютович К. Л., Шахмаев А. А. Спектры примесной фотопроводимости: донор-фосфор в твердом растворе $\text{Ge}_x\text{Si}_{1-x}$. 10, 1833
- Васильев В. А., см. Атаев Х. 8, 1350
- Васильев В. А., см. Баранов А. Н. 1, 99
- Васильева М. В., см. Бабицкий Ю. М. 5, 838
- Васильева М. В., см. Бабицкий Ю. М. 10, 1824
- Вашенко В. А., Водаков Ю. А., Гафийчук В. В., Дацко Б. И., Кернер Б. С., Литвин Д. П., Осипов В. В., Роенков А. Д., Санкин В. И. Образование и эволюция нитей лавинного тока в обратнорасположенных $p-n$ -переходах на основе $6H\text{-SiC}$. 7, 1209
- Вейс А. Н. Влияние обменного взаимодействия электронов на параметры зонной структуры и примесных состояний в селениде свинца. 11, 1934
- Велецкас Д., см. Балтрамеюнас Р. 4, 736
- Велиюлин Э. И., см. Олешко Е. В. 6, 1073
- Велицкая Е. М., Еремин В. К., Иванов А. М., Игнатенко Е. С., Строкан Н. Б., Турбеков У. Ш., Борани И., Шмидт Б. К. вопросу о спектре глубоких уровней, создаваемых в кремниевых детекторах излучений α -частицами. 5, 852
- Веренчикова Р. Г., см. Вавилов В. С. 4, 762
- Ветров А. П., см. Бузанова Е. В. 7, 1124
- Вигдорович Е. Н., Гольдберг Ю. А., Дурдымурадова М. Г., Мелебаев Д., Царенков Б. В. Коротковолновая фоточувствительность поверхностно-барьерных структур: влияние промежуточного диэлектрического слоя. 8, 1419
- Вилисова М. Д., см. Астрова Е. В. 5, 898
- Винник Е. В., Глинчук К. Д., Гурошев В. И., Прохорович А. В. Влияние облучения быстрыми нейтронами на люминесценцию арсенида галлия. 1, 82
- Виноградова Г. И., см. Соловьева Е. В. 6, 965
- Винокуров Д. А., Лантратов В. М., Синицын М. А., Улин В. П., Фалеев Н. Н., Федорова О. М., Шайович Я. Л., Явич Б. С. Свойства и особенности кристаллизации эпитаксиальных слоев GaAs , выращенных на подложках $\text{Si}(100)$ методом двухстадийного осаждения в МОС гидридном процессе. 6, 1022
- Винокуров Л. А., Фукс Б. И. Нелинейный фотоотклик в примесных полупроводниках. 11, 2003
- Власкин А., см. Томашюнас Р. 6, 1034
- Власюк В. И., см. Бейсюк П. П. 6, 961
- Водаков Ю. А., см. Вавилов В. С. 4, 762
- Водаков Ю. А., см. Вашенко В. А. 7, 1209
- Водопьянов Л. К., см. Алещенко Ю. А. 7, 1259
- Волков А. С., см. Атаев Ж. 8, 1350
- Волкова Е. А., Попов А. М., Поповичера О. Б. Динамические характеристики туннелирования электронов через двухъявную квазипараболическую квантовую яму. 9, 1618
- Воробкало Ф. М., см. Ионов А. Н. 3, 413
- Воробьев Ю. В., Захарченко В. Н., Кильчицкая С. С., Комаренко Р. П., Скрышевский В. А., Стриха В. И. Неадекватность и неустойчивость фототока квазиднородных пленок аморфного кремния. 2, 334
- Воробьева В. В., Зущинская О. В., Лебедев В. Б., ЛеТуан, Новиков С. В., Полянская Т. А., Савельев И. Г., Шмарцев Ю. В. Электрофизические параметры слоев GaAs , выращенных ЖФЭ из растворов-расплавов в галлии и висмуте при различных потоках водорода. 10, 1758
- Воронина Т. И., Джуртанов Б. Е., Лагунова Т. С., Яковлев Ю. П. Поведение примесей в твердых растворах $p\text{-GaInSbAs}$. 2, 283
- Воронина Т. И., Лагунова Т. С., Михайлова М. П., Сиповская

- М. А., Шерстнев В. В., Яковлев Ю. П. Электрические и фотоэлектрические свойства узкозонных твердых растворов GaInSbAs: Мн. 2, 276
- Ворогина Т. И., Лагунова Т. С., Моисеев К. Д., Прокофьева Н. А., Попова Т. Б., Силовская М. А., Шерстнев В. В., Яковлев Ю. П. Электрические и фотоэлектрические свойства твердых растворов InAsSbP. 9, 1639
- Воронков В. Б., Грехов И. В., Козлов В. А. Контроль качества интерфейса методом лазерного сканирования при прямом сращивании кремниевых пластин. 2, 208
- Воронков В. П., Вяткин А. П., Кулешов С. М., Муленков С. Ю. Температурная зависимость вольт-амперных характеристик контактов Pd-GaAs, подвергнутых лазерному отжигу. 4, 695
- Воскобойников А. М., см. Бродовой В. А. 4, 624
- Вуль А. Я., Вуль С. П., Саидашев И. И., Петросян П. Г. Полевой транзистор с $p-n$ -переходом в качестве затвора на основе твердых растворов GaAs_{1-x-y}Sb_xP_y. 10, 1718
- Вуль С. П., см. Вуль А. Я. 10, 1718
- Вывенко О. Ф., Давыдов И. А., Лучина В. Г., Целищев С. Л. Фотоэлектрические процессы в сульфиде кадмия с изovalентной примесью теллура. 10, 1745
- Выграненко Ю. К., см. Слынько В. В. 10, 1836
- Выдрик В. Н., Зубкова Т. И., Ильин В. И., Немов С. А., Рабизо О. В. Неидеальный гетеропереход p -PbTe- n -Si. 1, 406
- Вьжигин Ю. В., Соболев Н. А., Грессеров Б. Н., Шек Е. И. Влияние атмосферы термособработки на образование центров с глубокими уровнями. 8, 1324
- Вьжигин Ю. В., см. Грессеров Б. Н. 5, 807
- Вяткин А. П., см. Воронков В. П. 4, 695
- Гавалешко Н. П., см. Грушка Г. Г. 5, 945
- Гавалешко Н. П., см. Слободян В. З. 5, 919
- Гавриленко В. И., Калугин Н. Г., Красильник З. Ф., Никонов В. В., Стариков Е. В., Шикторов Н. Н. Индуцированное циклотронное излучение тяжелых дырок в одноосно деформированном германии. 4, 718
- Гавриленко В. И., Красильник З. Ф., Никонов В. В., Стариков Е. В., Шикторов П. Н. Теоретическое и экспериментальное исследование ВАХ и ГАХ горячих дырок кремния. 8, 1315
- Гаврушин В. И., см. Рыжиков В. Д. 5, 841
- Гаджиев А. З., см. Абдуллаев А. А. 1, 30
- Гайбуллаев С., см. Брунков П. Н. 2, 338
- Гамарц Е. М., см. Амальская Р. М. 3, 529
- Гарбузов Д. З., Бернштейн И. Э., Ильин Ю. В., Ильинская Н. Д., Овчинников А. В., Пихтин Н. А., Рассудов Н. Л., Тарасов И. С. Совершенствование процесса зарощивания и получение однодиодных зарощенных InGaAsP/InP-лазеров ($\chi = 1.3$ мкм) с мощностью излучения 160 мВт. 8, 1414
- Гарбузов Д. З., Овчинников А. В., Пихтин Н. А., Соколов В. Н., Тарасов И. С., Халфин З. Б. Экспериментальное и теоретическое исследование особенностей пороговых и мощностных характеристик РО ДГС InGaAsP/InP-лазеров ($\lambda = 1.3$ мкм). 5, 928
- Гарягдыев Г., Городецкий И. Я., Джумаев Б. Р., Корсунская Н. Е., Раренко И. М., Шейнкман М. К. Механизмы изменения электрических и фотоэлектрических свойств монокристаллов твердых растворов Zn_xCd_{1-x}Te под действием ультразвука. 3, 409
- Гасанзаде С. Г., Жадько И. П., Зинченко Э. А., Фридрих Е. С., Шепельский Г. А. Влияние анодного окисления поверхности на характеристики фотопроводимости и фотомгнитного эффекта в кристаллах Cd_xHg_{1-x}Te. 5, 871
- Гасапов С. И., см. Баженов Н. Л. 12, 2196
- Гафийчук В. В., Кернер Б. С., Осипов В. В., Щербаченко Т. М. Образование пульсирующих термодиффузионных автосолюитонов и турбулентности в неравновесной электронно-дырочной плазме. 10, 1696
- Гафийчук В. В., см. Ващенко В. А. 7, 1209
- Гашимзаде Н. Ф., Ивченко Е. Л. Граничные условия и эффективная масса электронов в сверхрешетке. 2, 323
- Гашимзаде Н. Ф., Пашабеков У. С. Спектр электронов в бесконечной узкой квантовой яме в бесщелевом полупроводнике. 12, 2217
- Гашка Р., см. Томашюнас Р. 6, 103
- Гельмонт Б. Л., см. Андаспаева А. А. 3, 394
- Гельмонт Б. Л., Зебря Г. Г. Температурная зависимость пороговой плотности тока инжекционного гетеролазера. 11, 2019
- Гельмонт Б. Л., Родина А. В. Энергия связи дырки на многозарядном акцепторе в полупроводниках со сгруппированной структурой алмаза. 12, 2489
- Георгиев Е. И., Гуцуляк Л. М., Иванов-Омский В. И., Маторов В. Ф., Смирнов В. А., Юдашев Ш. У. Влияние концентрации марганца на спектр фотолюминесценции GaSb. 11, 2024
- Георгиев Е. И., Гуцуляк Л. М., Иванов-Омский В. И., Поглецкий В. М., Смирнов В. Э. Экситон-фононная фотолюминесценция широкозонных сплавов Hg_{1-x}Cd_xTe. 12, 2177
- Георгиев Е. И., Гуцуляк Л. М., Иванов-Омский В. И., Сми

- нов В. А., Юлдашев Ш. У. Фотолюминесценция антимонида галлия, легированного марганцем. 11, 1960
- Георгицэ Е. И., Иванов - Омский В. И., Мастеров В. Ф., Мунтяну Ф. М. О влиянии магнитных примесей на гальваномагнитные явления антимонида галлия p -типа проводимости. 9, 1589
- Георгицэ Е. И., Иванов - Омский В. И., Мовилэ В. Ф., Цицишка Д. И. ИК магнитооптические резонансы в полумагнитных сплавах $Hg_{1-x}Cd_xMn_yTe$. 1, 41
- Георгобиани А. Н., Грузиццев А. Н., Заяц А. В., Буреес А. В., Левит А. Д. Влияние низкотемпературного отжига на дефектную структуру кристаллов $CdS : Li$. 3, 390
- Гергель В. А., Ильичев Э. А., Полторацкий Э. А., Родионов А. В., Тарнавский С. П., Федоренко А. В. Частотная дисперсия крутизны в полевых транзисторах на основе δ -легированных структур. 11, 1870
- Гергель В. А., Лукьянченко А. И., Соляков А. Н., Ильичев Э. А., Полторацкий Э. А. Температурная зависимость эффекта управления транзистором через полупроводящую подложку в ИС на арсениде галлия. 9, 1667
- Герчиков Л. Г., Субашиев А. В. Влияние гофрировки энергетического спектра на размерное квантование в полупроводниках с вырожденной валентной зоной. 2, 231
- Гершензон Е. М., Грачев С. А., Литвак - Горская Л. Б. Механизм преобразования частоты в n - $InSb$ -смесителе. 11, 1986
- Гершензон Е. М., Гурвич Ю. А., Мельников А. П., Шестаков Л. Н. Верхняя зона Хаббарда и проводимость по примесям некомпенсированного кремния. 1, 160
- Гинзбург Л. П. Влияние температуры на фотопроводимость, обусловленную D^- -центрами. 2, 311
- Глазов В. М., Кольцов В. Б., Кузова В. З., Регель А. Р., Таран Ю. Н., Тимошина Г. Г., Узлов К. И., Фалькевич Э. С. Структурные превращения при нагреве монокристаллов кремния. 4, 588
- Глинчук К. Д., см. Винник Е. В. 1, 82
- Глузман Н. Г., Леринман Н. К., Сабирзянова Л. Д., Цидильковский И. М., Паранчич С. Ю., Паранчич Ю. С. Резонансный донорный уровень хрома в селениде ртути. 1, 121
- Говалешко Н. П., см. Домашевская Э. П. 5, 893
- Гоголадзе Д. Т., Долгинов Л. М., Малькова Н. В., Мильвидский М. Г., Новикова В. М., Соловьева Е. В., Шепекина Р. В. Особенности жидкофазной эпитаксии и электрофизических свойств эпитаксиальных слоев $In_{0.53}Ga_{0.47}As : Sb$. 3, 475
- Гоголадзе Д. Т., см. Соловьева Е. В. 6, 965
- Голик Л. Л., Кунькова З. Э. О механизме фотопроводимости кристаллов магнитного полупроводника $CdCr_2Se_4$. 11, 1883
- Голикова О. А. Легирование и псевдолегирование аморфного гидрированного кремния (обзор). 9, 1517
- Голикова О. А., Бабаходжаев У. С., Казанин М. М., Мездрогина М. М. Плотность состояний и перенос дырок в аморфном гидрированном кремнии. 1, 102
- Голикова О. А., Бабаходжаев У. С., Казанин М. М., Мездрогина М. М., Арлаускас К., Юшка Г. Удельные сдвиги носителей тока и плотность состояний аморфного гидрированного кремния. 3, 551
- Голикова О. А., Домашевская Э. П., Мездрогина М. М., Сорокина К. Л., Терехов В. А., Тростянский С. Н. Плотность состояний хвоста валентной зоны и фотопроводимость аморфного гидрированного кремния. 8, 1448
- Голикова О. А., Казанин М. М., Мездрогина М. М., Захарова Н. Б., Ятлинко И. И., Петров И. Н. Исследование фотопроводимости аморфного гидрированного кремния методом видикона. 1, 170
- Головей В. М., см. Сырбу Н. Н. 10, 1721
- Головин А. В., см. Андреев С. П. 1, 128
- Гольдберг Ю. А., см. Вигдорович Е. Н. 8, 1419
- Гольдберг Ю. А., Поссе Е. А., Царенков Б. В., Шульга М. И. Термоэлектронный обратный ток в $GaAs$ поверхность-барьерной структуре. 3, 439
- Гольдин А. А., Сурис Р. А. Влияние спин-орбитального взаимодействия на пограничные состояния на гетеропереходах. 5, 934
- Гончарова А. Г., Зуев В. В. Влияние U^- -центров на термостимулированный ток в полупроводнике. 7, 1249
- Горбань С. И., см. Бабенцов В. Н. 4, 756
- Горбань С. И., см. Бабенцов В. Н. 7, 1243
- Горбатюк И. Н., см. Баранский П. И. 7, 1183
- Гордеев В. Н., см. Лигачев В. А. 9, 1536
- Гореленок А. Т., Рехвиашвили Д. Н., Надточий М. Ю., Устинов В. М. $In_{0.53}Ga_{0.47}As/In_{0.88}Ga_{0.12}As_{0.23}P_{0.77}$ -гетероструктуры с двумерным электронным газом. 5, 908
- Горнушкина Е. Д., Дидик В. А., Козловский В. В., Милкович Р. Ш. Распределение фосфора, созданного в кремнии облучением высокоэнергетичными α -частицами. 11, 2044
- Горобец Н. В., Гудыма Ю. В., Лихобабин Н. П. Волны переключения при обратном тепловом пробое в полупроводниковых пластинах. 8, 1453
- Городецкий И. Я., см. Бабенцов В. Н. 7, 1243
- Городецкий И. Я., см. Гарягдыев Г. 3, 409
- Городилов Н. А., см. Нейфельд Э. А. 8, 1463

- Городниченко О. К. Ротационный механизм пластической деформации в эпитаксиальных структурах арсенида галлия. 5, 947
- Городничий О. П., см. Беляев А. Е. 7, 1164
- Горольчук И. Г., см. Абрамов В. В. 3, 513
- Грацианская Е. И., см. Лобов Г. Д. 9, 1560
- Грачев С. Е., см. Гершензон Е. М. 11, 1986
- Гременок В. Ф., см. Киндяк В. В. 9, 1655
- Гременок В. Ф., см. Матяс Э. Е. 9, 1656
- Грессеров Б. Н., Соболев Н. А., Выжигин Ю. В., Елисеев В. В., Лихунов В. М. Влияние атмосферы термообработки на диффузию алюминия в кремнии. 5, 807
- Грессеров Б. Н., см. Выжигин Ю. В. 8, 1324
- Грехов И. В., Зазулин С. В., Кардо-Сысоев А. Ф. Ударная ионизация в кремнии в слабых полях. 5, 885
- Грехов И. В., см. Воронков В. Б. 2, 208
- Грибников З. С., Железняк В. Б. Двумерные ганновские домены в структурах с полевым электродом. 1, 17
- Грибников З. С., Райчев О. Э. X-управление туннельным током Г-электронов в ГХГ-гетероструктуре. 5, 859
- Грибников З. С., см. Борблик В. Л. 8, 1302
- Григорьев К. П., см. Киндяк В. В. 9, 1655
- Григорьев Н. Н., Ергаков В. К., Карачевцева Л. А., Курбанов К. Р., Любченко А. В., Маловичко Э. А. Электронное время жизни в кристаллах $Cd_xHg_{1-x}Te$ с разной плотностью малоугловых границ. 9, 1649
- Григорьев Н. Н., Карачевцева Л. А., Курбанов К. Р., Любченко А. В. Влияние ростовых дислокаций на время жизни электронов в $n-Cd_xHg_{1-x}Te$. 3, 464
- Григорян Л. Н., см. Варданян Г. А. 2, 295
- Гринштейн П. М., см. Бабицкий Ю. М. 5, 838
- Гринштейн П. М., см. Бабицкий Ю. М. 10, 1824
- Грицак Б. Н., Сирота А. В., Халамейде Д. Д. Долговременные релаксации проводимости в нелегированном антимониде кадмия. 12, 2135
- Гришечкина С. П., Журавлев А. А., Моллманн К.-П., Херрманн К. Х. Резонансный внутрицентровый переход в теллуриде свинца, легированном галлием. 4, 677.
- Гроза А. А., Круликовская М. П., Старчик М. И., Антоненко Р. С. Поведение кислорода в монокристаллическом кремнии при высокотемпературной обработке в γ -поле. 10, 1821
- Громовой Ю. С., Пляцко С. В., Костюнин Г. Е. Суперсверхтонкая структура в спектрах ЭПР ионов Eu^{2+} в тонких пленках $PbTe$. 6, 1083
- Громовой Ю. С., см. Пляцко С. В. 3, 427
- Громовой Ю. С., см. Сизов Ф. Ф. 12, 2158
- Грузинцев А. Н., см. Георгбиани А. Н. 3, 390
- Грушка Г. Г., Гавалешко Н. П., Грушка З. М. Отрицательное дифференциальное сопротивление в полупроводниках со стехиометрическими вакансиями. 5, 945
- Грушка Г. Г., см. Домашевская Э. П. 5, 893
- Грушка Г. Г., см. Малик А. И. 10, 1691
- Грушка З. М., см. Грушка Г. Г. 5, 945
- Гудыма Ю. В., см. Горобец Н. В. 8, 1453
- Гульбинас В., см. Балтрамюнас Р. 2, 271
- Гуменюк-Сычевская Ж. В., Сизов Ф. Ф. Динамика нелинейной рефракции в структурах с квантовыми ямами $PbTe/Pb_{1-x}Sn_xTe$. 5, 913
- Гуральник И. Р., см. Алимпов В. Н. 12, 2105
- Гурвич Ю. А., см. Гершензон Е. М. 1, 160
- Гуревич С. А., Федорович А. Е., Федоров А. В. Исследование краевого поглощения света в легированном GaAs при комнатной температуре. 5, 769
- Гуревич Ю. Г., Логвинов Г. Н. Нелинейный токоперенос в полупроводниковых субмикронных образцах с обедненными поверхностями слоями. 5, 792
- Гуревич Ю. Г., Юрченко В. Б. Проблема формирования ЭДС в полупроводниках и вывода ее во внешнюю цепь. 12, 2109
- Гурушев В. И., см. Винник Е. В. 1, 82
- Гуртов В. А., Травков И. В. Моделирование процесса накопления объемного заряда в диэлектриках МДП структур при облучении МНОП структуры $Si-SiO_2-Si_3N_4-Me$. 3, 385
- Гусаков Г. М., Кондратов Т. Н., Миняждинов М. С., Ларюшин А. И. О природе точечных дефектов в GaAs, возникающих при импульсном лазерном облучении. 3, 369
- Гусев Г. М., Квон З. Д., Лубышев Д. И., Мигаль В. П., Погосов А. Г. Квантовый перенос в δ -легированных слоях GaAs. 4, 601
- Гусев О. Б., см. Бреслер М. С. 2, 298
- Гусев О. К., см. Андерсен Г. Ю. 11, 1999
- Гусейнов А. М., см. Джафарова С. З. 6, 983
- Гуткин А. А., Седов В. Е., Папульников А. Ф. Фотолюминесценция, связанная с центрами Au_{Ga} в GaAs: Au. 3, 508
- Гуткин А. А., см. Аверкиев Н. С. 1, 50
- Гуткин А. А., см. Аверкиев Н. С. 1, 58
- Гуткин А. А., см. Аверкиев Н. С. 11, 1967
- Гуткин А. А., см. Аверкиев Н. С. 11, 1976
- Гуцев Г. Л., см. Мякенькая Г. С. 6, 970
- Гуцуляк Л. М., см. Георгице Е. И. 7, 1217
- Гуцуляк Л. М., см. Георгице Е. И. 11, 1960

- Гудуляк Л. М., см. Георгицэ Е. И. 11, 2024
- Гучмазов А. Б., Родригес Х.-А., Румянцев В. Д. Бесконтактное измерение электрических и фотоэлектрических параметров гетероструктур с p - n -переходом в люминесцирующем материале. 1, 143
- Давыдов И. А., см. Вывенко О. Ф. 10, 1745
- Данилов В. А., см. Бойков Ю. А. 7, 1246
- Данилов В. И., см. Даунов М. И. 3, 467
- Данилюк Г. В., см. Слынько В. В. 10, 1836
- Даунов М. И., Магомедов А. Б., Данилов В. И. Влияние давления на явления переноса в $\text{CdSnAs}_2\langle\text{Cu}\rangle$ с глубоким акцепторным уровнем. 3, 467
- Дацко Б. И., см. Ващенко В. А. 7, 1209
- Дашевский З. М., см. Акимов Б. А. 2, 250
- Двуреченский А. В., Каранович А. А., Колесникова О. Л. ЭПР мелких доворов в квантовых ямах: водородоподобная модель. 5, 923
- Демидов Е. В., см. Алешкин В. Я. 6, 1047
- Денисенко С. Г., см. Асеев А. Л. 4, 582
- Денисов В. Н., Маврин Б. Н., Новиков С. В., Чалдышев В. В., Шмарцев Ю. В. Комбинационное рассеяние в эпитаксиальных пленках GaAs, легированных изovalентными примесями Bi и In: влияние дефектов и затухание плазмофонона. 8, 1472
- Денисов В. П., Пашук А. В. Фотоэлектрические процессы на границе полупроводник—изотопный жидкий диэлектрик (GaAs, Si—органические растворители). 8, 1381
- Денотки В. Л., Козиков С. А., Кригель В. Г., Козлова С. В. Исследование субмикронных эпитаксиальных слоев, глубоко лежащих в структуре на основе $\text{GaAs}-\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$. 8, 1397
- Джафарова С. З., Рагимова Н. А., Абуталыбов Г. И., Гусейнов А. М., Абдинов А. Ш. Экситонные состояния в легированных монокристаллах InSe и GaSe. 6, 983
- Джаманбалин К. К., Дмитриев А. Г., Евстропов В. В., Шульга М. И. Возникновение туннельного тока в структурах металл—полупроводник после воздействия лазерного излучения. 10, 1774
- Джумаев Б. Р., см. Булах Б. М. 11, 1946
- Джумаев Б. Р., см. Гарягдыев Г. З. 409
- Джумамухамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г. Температурная зависимость фотолюминесценции модифицированных кристаллов $\text{GaAs}\langle\text{Te}\rangle$. 1, 93
- Джумамухамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г. Влияние легирующей примеси исходного кристалла на люминесцентные свойства модифицированного GaAs. 9, 1569
- Джумамухамбетов Н. Г., Дмитриев А. Г., Уханов Ю. И. Краевое поглощение GaAs, модифицированного лазерным излучением. 1, 168
- Джумамухамбетов Н. Г., см. Андреева В. Д. 9, 1624
- Джуртанов Б. Е., см. Андаспарова А. А. 3, 394
- Джуртанов Б. Е., см. Воронина Т. И. 2, 283
- Дидик В. А., см. Горнушкина Е. Д. 11, 2044
- Дидык А. Ю., см. Аль-Баккур Ф. 10, 1841
- Дмитриев А. Г., см. Андреева В. Д. 9, 1624
- Дмитриев А. Г., см. Джаманбалин К. К. 10, 1774
- Дмитриев А. Г., см. Джумамухамбетов Н. Г. 1, 93
- Дмитриев А. Г., см. Джумамухамбетов Н. Г. 1, 168
- Дмитриев А. Г., см. Джумамухамбетов Н. Г. 9, 1569
- Дмитриев С. Г., Рыльков В. В., Шагимуратов О. Г. О характере рассеяния носителей заряда на мелких нейтральных центрах в полупроводниках. 2, 360
- Дмитрук Н. Л., см. Борковская О. Ю. 3, 487
- Доброго В. П., Доросинец В. А. Нелинейные электрические явления в сильно легированном и сильно компенсированном арсениде галлия. 10, 1797
- Добровинский Ю. М., Махкамов Ш., Мирзаев А., Митин В. И., Турсунов Н. А. Влияние терморadiационной обработки на процесс образования дефектных центров в кремнии при электронном облучении. 3, 523
- Довгий Я. О., Китык И. В. Фотокинетические явления в монокристаллах Ti_2SbS_3 . 10, 1839
- Долгинов Л. М., см. Гогаладзе Д. Т. 3, 475
- Долгинов Л. М., см. Соловьева Е. В. 6, 965
- Доманская Л. И., см. Нейфельд Э. А. 8, 1463
- Домашевская Э. П., Неврюева Е. Н., Грушка Г. Г., Говалешко Н. П., Баев А. С., Терехов В. А. Влияние стехиометрических вакансий на поведение потолка валентной зоны в твердых растворах $(\text{In}_2\text{Te}_3)_x-(\text{HgTe})_{1-x}$. 5, 893
- Домашевская Э. П., см. Голикова О. А. 8, 1448
- Доросинец В. А., см. Доброго В. П. 10, 1797
- Дравин В. А., см. Абрамов В. С. 8, 1355
- Дроздова И. А., Корсунская Н. Е., Маркевич И. В., Шульга Е. П., Шейнкман М. К. Образование структуры, ответственной за аномальную температурную зависимость проводимости грани (0001) кристаллов CdS. 9, 1629
- Дружинин Ю. П., Чиркова Е. Г. Сечение оптического поглощения мелкодопора в германии. 2, 307

- Дрюков В. Г., см. Манаков С. М. 9, 1601
- Дряхлушин В. Ф. Параметрическое усиление объемных и поверхностных электромагнитных волн в тонком слое полупроводниковой сверхрешетки. 2, 348
- Дурдымурадова М. Г., см. Вигдорович Е. Н. 8, 1419
- Дыкман И. М. Электромагнитные волны в сверхрешетке многодолинного полупроводника при наличии магнитного поля. 1, 151
- Дымова Н. Н., см. Абрамов В. С. 8, 1355
- Дышловенко П. Е., см. Васильев В. А. 10, 1833
- Дьяконова Н. В. Немонотонная зависимость величины шума $1/f$ от интенсивности подсветки в GaAs. 2, 358
- Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. Температурная зависимость низкочастотного шума в структурно совершенном и подвергнутом деструктивному сжатию GaAs. 2, 355
- Дьяконова Н. В., Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. Природа объемного шума $1/f$ в GaAs и Si (обзор). 12, 2065
- Евстропов В. В., см. Джаманбалин К. К. 10, 1774
- Егоров К. Н., см. Акимов Б. А. 2, 250
- Екимов А. Н., см. Балтрамеюнас Р. 2, 271
- Елисеев В. В., см. Грессеров Б. Н. 5, 807
- Емельянова Е. В., см. Архипов В. И. 10, 1792
- Емельянова Е. В., см. Архипов В. И. 12, 2222
- Емцев В. В., Клингер П. М., Машовец Т. В. Влияние параметров электронного облучения на сечение образования собственных дефектов в кремнии. 1, 45
- Емцев В. В., Клингер П. М., Миразиян К. М. Зависимость скорости образования вторичных дефектов в p -Si от интенсивности электронного облучения. 3, 561
- Емцев В. В., Клингер П. М., Фистуль В. И., Шмарцев Ю. В. Особенности взаимодействия изовалентной примеси германия с собственными дефектами в кремнии. 6, 997
- Емцев В. В., Машовец Т. В., Нелоскин Д. С. Проявление пар Френкеля в p -германии при низкотемпературном γ -облучении. 2, 191
- Ергаков В. К., см. Григорьев Н. Н. 9, 1649
- Еремин В. К., см. Вербицкая Е. М. 5, 852
- Ермаков Е. Н., Коломеец В. В., Панасюк Л. И., Родионов В. Е. Переход металл—диэлектрик в n -Si<P, Sb> при высоких одноосных давлениях. 1, 179
- Ершов В. С., Зайцевская З. А., Кальфа А. А., Крюков А. Р., Матыцын С. В., Пашковский А. Б., Федоров Ю. Ю. Влияние глубоких уровней на вольт-амперные характеристики гетероструктурных полевых транзисторов с селективным легированием. 5, 776
- Жадько И. П., см. Гасан-заде С. Г. 5, 871
- Жданович Н. С., см. Абдулвагабов М. Ш. 1, 77
- Железняк А. Т., Шмелев Г. М. Фотостимулированное нечетное магнитосопротивление полупроводника при рассеянии электронов заряженными примесями. 1, 171
- Железняк А. Т., см. Эпштейн Э. М. 6, 1098
- Железняк В. Б., см. Грибников З. С. 1, 17
- Жилев Ю. В., см. Акимов А. В. 4, 713
- Жиндулис А., см. Томашюнас Р. 6, 1070
- Житинская М. К., см. Мельник Р. Б. 3, 444
- Житинская М. К., см. Немов С. А. 1, 114
- Житинская М. К., см. Немов С. А. 6, 979
- Житинская М. К., см. Немов С. А. 9, 1634
- Жовнир Г. И., см. Бабенцов В. Н. 4, 756
- Жуковский П. В., Канторов С. Б., Кищак К., Мончка Д., Стельмах В. Ф. Аномальная зависимость коэффициента отражения Si от дозы имплантации ионов Ag^+ при $T < 330$ К. 3, 556
- Журавлев А. А., см. Гришечкина С. П. 4, 677
- Журавлев К. С., Катков А. В. Влияние изовалентного легирования In и Sb на фотолюминесценцию комплексов в эпитаксиальном сильно легированном p -GaAs:Ge. 1, 88
- Журавлев К. С., Терехов А. С., Шамирзаев Т. С. Температурная зависимость рекомбинации через уровни комплексов в сильно легированном эпитаксиальном p -GaAs:Ge. 10, 1811
- Заблоцкий В. В., см. Иванов Н. А. 3, 553
- Заварицкая Э. И., Ипатова И. А., Мирлин Д. Н., Мурзин В. Н., Пермогоров С. А., Пикус Г. Е., Сурис Р. А., Тимофеев В. Б., Тиходеев С. Г., Шейнкман М. К., Акимченко И. П., Вавалов В. С. О XX Международной конференции по физике полупроводников. 7, 1263
- Заднипру И. Б., см. Сырбу Н. Н. 5, 783
- Заднипру И. Б., см. Сырбу Н. Н. 8, 1366
- Заднипру И. Б., см. Сырбу Н. Н. 9, 1542
- Заднипру И. Б., см. Сырбу Н. Н. 10, 1721
- Зазулин С. В., см. Грехов И. В. 5, 885
- Зайтов Ф. А., см. Андерсен Г. Ю. 11, 1999

- Зайцевская З. А., см. Ершов В. С. 5, 776
- Зарубин Л. И., см. Ионов А. Н. 3, 413
- Захаров Ю. В., см. Спириин А. И. 1, 173
- Захарова А. А., Рыжий В. И. Осцилляции вольт-амперных характеристик монополярных транзисторных структур с квантовой ямой. 3, 402
- Захарова А. А., см. Федирко В. А. 9, 1607
- Захарова Н. Б., см. Голикова О. А. 1, 170
- Захаренков Л. Ф., см. Мастеров В. Ф. 8, 1375
- Захарченко В. Н., см. Воробьев Ю. В. 2, 334
- Захвалинский В. С., см. Кульбачинский В. А. 12, 2201
- Заяц А. В., см. Георгобиани А. Н. 3, 390
- Звонков Б. Н., см. Алешкин В. Я. 6, 1047
- Звягин И. П., см. Беляев А. Д. 1, 35
- Зегря Г. Г., см. Андаспаева А. А. 3, 394
- Зегря Г. Г., см. Гельмонт Б. Л. 11, 2019
- Зейналов Э. З., см. Нифтиев Г. М. 4, 704
- Зимогорова Н. С., Карлина Л. Б., Никитин Л. П. Особенности фотолуминесценции легированного марганцем твердого раствора $In_{0.53}Ga_{0.57}As$ в условиях изменения состояния гетерограницы $InP-InGaAs$. 7, 1253
- Зиновьев Н. Н., см. Бланк А. Ю. 1, 67
- Зиченко Э. А., см. Гасан-заде С. Г. 5, 871
- Знаменский Д. А., Тодуа П. А., Шестакова Е. Ф., Эльтазаров Б. Т., Юсупов Р. Г. Фотогальванические свойства структур металл-легированная пленка перфторированного полимера—арсенид галлия. 12, 2219
- Зотов К. И., см. Бабич В. М. 1, 118
- Зубков В. И., Ким Ха Ен, Копылов А. А., Соломонов А. В. Нестационарная емкостная спектроскопия глубоких уровней в полупроводниковых твердых растворах: метод определения функции плотности состояний. 12, 2163
- Зубкова Т. И., см. Выдрик В. Н. 1, 106
- Зубрилов А. С., см. Аникин М. М. 3, 479
- Зубрилов А. С., Ковешников С. В. Влияние примесного состава $n-Si$ на радиационное дефектообразование и деградацию времени жизни неосновных носителей заряда при γ -облучении. 8, 1332
- Зуев В. В., см. Гончарова А. Г. 7, 1249
- Зушинская О. В., см. Воробьева В. В. 10, 1758
- Зыков В. Г., Сердега Б. К. Поляризационно зависящая фотомагнитная ЭДС в критических точках зонного спектра германия. 12, 2173
- Иванов А. И., см. Вавилов В. С. 4, 762
- Иванов А. М., см. Вербицкая Е. М. 5, 852
- Иванов Л. П., см. Бланк А. Ю. 1, 67
- Иванов Н. А., Заблоцкий В. В. Оптимизация условий облучения при ядерном легировании полупроводников. 3, 553
- Иванов П. А., Царенков Б. В. SiC СВЧ полевые транзисторы: граничная частота—мощность. 11, 1913
- Иванов Ю. Л., Шик А. Я. Влияние магнитного поля на межуровневую релаксацию двумерных электронов. 9, 1670
- Иванов-Омский В. И., Миринов К. Е., Мынбаев К. Д., Богобайши В. В. Изменение дефектной структуры $Cd_xH_{21-x}Te$ при легировании индием. 8, 1423
- Иванов-Омский В. И., см. Баженов Н. Л. 6, 1103
- Иванов-Омский В. И., см. Баженов Н. Л. 12, 2196
- Иванов-Омский В. И., см. Белотелов С. В. 6, 1058
- Иванов-Омский В. И., см. Георгиц Е. И. 1, 41
- Иванов-Омский В. И., см. Георгиц Е. И. 7, 1217
- Иванов-Омский В. И., см. Георгиц Е. И. 9, 1589
- Иванов-Омский В. И., см. Георгиц Е. И. 11, 1960
- Иванов-Омский В. И., см. Георгиц Е. И. 14, 2024
- Иванцов Л. Ф., см. Берковиц В. Л. 3, 379
- Иванюкович В. А., см. Андриевский В. Ф. 2, 222
- Ивашова Т. А., см. Кадушкин В. И. 3, 566
- Иващенко А. И., Коланская Ф. Я., Соломонов А. И., Гарченко В. П. Электронные ловушки, наведенные в $n-GaP$ ионным легированием фосфором. 9, 1658
- Ивлева О. М., см. Астрова Е. В. 5, 898
- Ивченко Е. Л., Кавокин А. В. Экситоны и примесные центры в полупроводниковой сверхрешетке в методе эффективной массы. 10, 1780
- Ивченко Е. Л., см. Гапимзаде Н. Ф. 2, 323
- Игнатенко Е. С., см. Вербицкая Е. М. 5, 852
- Ижнин А. И., см. Баженов Н. Л. 6, 1103
- Ижнин А. И., см. Белотелов С. В. 6, 1058
- Йодказис С., см. Нятикшис В. 9, 1646
- Илащук М. И., см. Бейсюк П. П. 6, 961
- Илиев Х. М., см. Бахадырханов М. К. 10, 1731
- Ильин В. И., см. Выдрик В. Н. 1, 106
- Ильин М. А., см. Бабицкий Ю. М. 5, 838
- Ильин Н. П., Мастеров В. Ф., Васильев А. Э. Модель бинарного полупроводника на основе самосогласованного метода непрерывных дробей. 2, 185
- Ильин Н. П., см. Васильев А. Э. 2, 203
- Ильин Ю. В., см. Гарбузов Д. З. 8, 1414

- Ильинская Н. Д., см. Гарбузов Д. З. 8, 1414
- Ильичев Э. А., см. Гергель В. А. 9, 1667
- Ильичев Э. А., см. Гергель В. А. 11, 1870
- Именков А. Н., см. Андаспаева А. А. 3, 394
- Ионов А. Н., Матвеев М. Н., Шлимак И. С., Воробкало Ф. М., Зарубин Л. И., Немиш И. Ю. Электрофизические свойства нейтрально легированного германия с измененным изотопным составом. 3, 413
- Ипатова И. А., см. Заварицкая Э. И. 7, 1263
- Исмагилова Ф. М., Литвак-Горская Л. Б., Луговая Г. Я., Трофимов И. Е. Особенности отрицательного магнитосопротивления при проводимости по верхней зоне Хаббарда в p -Si(B). 2, 255
- Кабанов В. Ф., Свердлов А. М. Исследование электрофизических свойств пленок магнитного полупроводника $\text{Eu}_{1-x}\text{Sm}_x\text{O}$. 8, 1388
- Кабулов И. А., см. Аллахвердиев А. М. 1, 177
- Кавокин А. В., Кавокин К. В. Автолокализация экситона в квантовой яме с полумагнитным барьером. 10, 1751
- Кавокин А. В., см. Ивченко Е. Л. 10, 1780
- Кавокин К. В., см. Кавокин А. В. 10, 1751
- Кадушкин В. И. Затухание квантования Ландау как метод изучения совершенства границы раздела гетероперехода с 2D-электронами. 3, 459
- Кадушкин В. И., Ивашова Т. А. Гетероструктура с 2D-электронами как датчик Холла. 3, 566
- Кадушкин В. И., Кульбачинский В. А. Фаза осцилляций магнитокинетических коэффициентов вырожденных двумерных электронов. 4, 612
- Казакевич Л. А., Лугаков П. Ф. Эффективность образования вакансионных и междоузельных комплексов при облучении бездислокационного n -кремния. 1, 110
- Казанин М. М., см. Голикова О. А. 1, 102
- Казанин М. М., см. Голикова О. А. 1, 170
- Казанин М. М., см. Голикова О. А. 3, 551
- Казанский А. Г., Кузнецов С. В. Температурная зависимость фотопроводимости в α -Si: H p -типа. 8, 1456
- Казлаускас А., см. Рыжиков В. Д. 5, 841
- Казначеев В. Ю., см. Чунь Гэн. 10, 1681
- Калинушкин В. П., Юрьев В. А., Муриш Д. И. Крупномасштабные скопления электрически активных дефектов в монокристаллах фосфида индия. 5, 798
- Калугин Н. Г., см. Гавриленко В. И. 4, 718
- Кальфа А. А., см. Ершов В. С. 5, 776
- Каминский В. Э. Релаксация на оптических фононах импульса и энергии горячих электронов в гетероструктурах. 3, 453
- Каневский В. М., см. Пашаев Э. М. 6, 1080
- Канторов С. Б., см. Жуковский П. В. 3, 556
- Каплан Б. И., Малютенко В. К., Щедрин А. И. Осцилляторный эффект в Ge в условиях поперечного градиента плотности плазмы. 11, 2011
- Капустин Ю. А., Колокольников Б. М. Глубокие уровни, возникающие в приповерхностной области кремния p -типа после диффузии золота. 1, 181
- Капустин Ю. А., см. Белявский В. И. 7, 1204
- Караваяев Г. Ф., Тиходеев Ю. С. Уравнения для огибающих в варизонной структуре. 7, 1237
- Каранович А. А., см. Двуреченский А. В. 5, 923
- Карась В. И., см. Андриевский В. Ф. 2, 222
- Карачевцева Л. А., см. Григорьев Н. Н. 3, 464
- Карачевцева Л. А., см. Григорьев Н. Н. 9, 1649
- Кардо-Сысоев А. Ф., Попова М. В. Нестационарные процессы двойной инжекции и рассасывания плазмы в полупроводниковой $p^+ - n - n^+$ -структуре. 1, 3
- Кардо-Сысоев А. Ф., см. Грехов И. В. 5, 885
- Карлина Л. Б., см. Зимогорова Н. С. 7, 1253
- Карпов С. Ю., Копьев П. С., Тер-Мартirosян А. Л., Чалый В. П., Шкурко А. П. Исследование взаимной тепловой влияния элементов лазерной линейки, работающей в квазинепрерывном режиме. 8, 1361
- Карпова А. П., см. Тиман Б. Л. 6, 1107
- Карпович И. А., см. Бедный Б. И. 8, 1450
- Карпович С. И., см. Тихов С. В. 3, 434
- Картавых А. В., см. Юрова Е. С. 10, 1827
- Касаманян З. А., см. Паносян Ж. Р. 6, 1030
- Касаткин А. П., см. Тихов С. В. 3, 434
- Касимова Г. А., см. Тагиев Б. Г. 11, 1877
- Касиян А. И., Сур И. В., Балмуш И. И. Подвижность 2D-электронов при их рассеянии на связанных плазмон-фононных колебаниях. 4, 689
- Касимова Р. С., Абдукаримова Х. Р. Зависимость времени жизни носителей тока в кремнии, легированном золотом, от степени компенсации. 9, 1566
- Катеринчук В. Н., Ковалюк М. Э. p - n -гомогенные InSe-фотодиоды. 5, 954
- Катков А. В., см. Журавлев К. С. 1, 88
- Кахраманов С. Ш., см. Оленко Е. В. 6, 1073
- Качурин Г. А., Тыщенко И. Е., Мажириш А. П., Федина Л. И. Свойства n -слоев, полученных высокотем-

- пературным внедрением ионов P^+ в кремний. 4, 596
- Качурин Г. А., см. Александров Л. Н. 2, 227
- Квон З. Д., Погосов А. Г. Численный расчет энергетического спектра электронов в тонких и δ -легированных слоях GaAs. 1, 138
- Квон З. Д., см. Гусев Г. М. 4, 601
- Кернер Б. С., см. Ващенко В. А. 7, 1209
- Кернер Б. С., см. Гафийчук В. В. 10, 1696
- Кильчицкая С. С., см. Воробьев Ю. В. 2, 334
- Ким Ха Ен, см. Зубков В. И. 12, 2163
- Киндяк А. С., см. Киндяк В. В. 9, 1655
- Киндяк В. В., Моисеенко В. В., Киндяк А. С., Гременок В. Ф., Корень Н. Н., Григорьев К. П. Определение оптических констант тонких пленок GeS, полученных импульсным лазерным испарением. 9, 1655
- Киннис М. М., см. Сысоев Б. И. 4, 708
- Киреевко В. П., см. Андерсен Г. Ю. 11, 1999
- Кириллов В. И., см. Спириин А. И. 1, 173
- Киркинский В. А., см. Курлева Р. Г. 6, 1040
- Киришт Ф., см. Артамонов В. В. 10, 1704
- Китык И. В., см. Довгий Я. О. 10, 1839
- Кицак К., см. Жуковский П. В. 3, 556
- Климакова Н. Н., Осипов Е. Б., Осипова Н. А., Цветкова Е. В. Роль обменного взаимодействия в пьезоспектроскопических свойствах экситона, связанного на акцепторе Sn в GaAs. 3, 558
- Клингер П. М., см. Емцев В. В. 1, 45
- Клингер П. М., см. Емцев В. В. 3, 561
- Клингер П. М., см. Емцев В. В. 6, 997
- Клопенков М. Л., см. Чапанов А. М. 3, 417
- Клюй Н. И., см. Артамонов В. В. 10, 1704
- Клячкин Л. Е., см. Баграев Н. Т. 4, 644
- Клячкин Л. Е., см. Баграев Н. Т. 9, 1613
- Ковалев Д. И., см. Бланк А. Ю. 1, 67
- Ковалевская Г. Г., Мередов М. М., Пенцов А. В., Руссу Е. В., Салихов Х. М., Слободчиков С. В. Токи двойной инжекции и фототок в диодных структурах $Pd-p-p^+-InP$. 8, 1466
- Ковальчук В. Б., см. Бабич В. М. 1, 118
- Ковалюк М. З., см. Катеринчук В. Н. 5, 954
- Ковешников С. В., см. Зубрилов А. С. 8, 1332
- Коджеспирова И. Ф., см. Костылев С. А. 12, 2184
- Козиков С. А., см. Деноткин В. Л. 8, 1397
- Козлов В. А., см. Воронков В. В. 2, 208
- Козлов Е. Б., см. Андреев В. А. 5, 880
- Козлов И. П., см. Аль-Баккур Ф. 10, 1841
- Козлова С. В., см. Деноткин В. Л. 8, 1397
- Козловский В. В., Кольченко Т. И., Ломако В. М. Влияние условий облучения на процессы дефектообразования в n -GaAs. 3, 545
- Козловский В. В., Кольченко Т. И., Ломако В. М. Эффективность введения электронных ловушек в арсениде галлия при высокотемпературном облучении электронами. 7, 1169
- Козловский В. В., Кольченко Т. И., Ломако В. М., Мороз С. Е. Дефектообразование в n -InP при повышенных температурах облучения. 2, 267
- Козловский В. В., см. Горнушкина Е. Д. 11, 2044
- Козуб В. И. Новые книги по полупроводникам. 2, 364; 6, 1108; 7, 1274; 8, 1476; 10, 1846.
- Козыренко В. Н., см. Олешко Е. В. 6, 1073
- Колесникова О. Л., см. Двуреченский А. В. 5, 923
- Колобов А. В., см. Бедельбаева Г. Е. 2, 197
- Колокольников Б. М., см. Капустин Ю. А. 1, 181
- Коломеец В. В., см. Ермаков Е. Н. 1, 179
- Кольцов В. Б., см. Глазов В. М. 4, 588
- Кольцов Г. И., Крутенюк Ю. В. Изменение механизмов прохождения тока в контакте $Au-InAs$ p -типа при имплантации протонов. 2, 245
- Кольцов Г. И., Макаров В. В. Некоторые эффекты, влияющие на профиль распределения внедренных ионов в кристаллических мишенях полупроводниковых соединений $A^{III}B^{V}$ после ионной имплантации. 3, 373
- Кольченко Т. И., Ломако В. М., Мороз С. Е., Пономарева О. А., Сергеева В. В., Цыпленков И. Н. Диагностика эпитаксиальных слоев GaAs, выращенных на кремниевых подложках, методами фотолюминесценции и емкостной спектроскопии. 9, 1574
- Кольченко Т. И., см. Козловский В. В. 2, 267
- Кольченко Т. И., см. Козловский В. В. 3, 545
- Кольченко Т. И., см. Козловский В. В. 7, 1169
- Компренко Р. П., см. Воробьев Ю. В. 2, 334
- Комиренко С. М., см. Баранский П. И. 7, 1183
- Комиренко С. М., см. Беляев А. Е. 7, 1164
- Комиренко Р. П., Литвиненко С. В., Скрышевский В. А., Стриха В. И., Кочка Я., Стухлик И. Структуры $a-Si:H/Si$ с перестраиваемой областью спектральной чувствительности. 11, 2034
- Кондратова Т. Н., см. Гусаков Г. М. 3, 369
- Конников С. Г., см. Брунков П. Н. 2, 338

- Константинов А. О. Инжекция неравновесных точечных дефектов при диффузии примесей в кристаллах со смешанным механизмом самодиффузии. 7, 1175
- Константинов О. В., см. Бычковский Д. Н. 4, 660
- Константинов О. В., см. Бычковский Д. Н. 11, 1889
- Константинова Н. Н., Магомедов М. А., Рудь В. Ю., Рудь Ю. В. Фотоактивное поглощение в тонких пленках CuInSe_2 . 11, 2047
- Копанская Ф. Я., см. Иващенко А. И. 9, 1658
- Копылов А. А., см. Баранов А. Н. 1, 99
- Копылов А. А., см. Васильев В. А. 10, 1833
- Копылов А. А., см. Зубков В. И. 12, 2163
- Копьев П. С., см. Карпов С. Ю. 8, 1361
- Корень Н. Н., см. Киндяк В. В. 9, 1655
- Коржувев М. А., Свечников Т. Е. Сверхбыстрые диффузионные эффекты в монокристаллах Bi_2Te_3 и $\text{Bi}_2\text{Te}_3\text{—Bi}_2\text{Se}_3$, легированных медью. 12, 2141
- Коробейникова Е. Н., см. Акимов Б. А. 2, 342
- Корсунская Н. Е., см. Бабенцов Б. Н. 7, 1243
- Корсунская Н. Е., см. Булах Б. М. 11, 1946
- Корсунская Н. Е., см. Гарягдыев Г. 3, 409
- Корсунская Н. Е., см. Дроздова И. А. 9, 1629
- Косарев А. И., см. Абдулвагабов М. Ш. 1, 77
- Костюнин Г. Е., см. Громовой Ю. С. 6, 1083
- Костюнин Г. Е., см. Пляцко С. В. 3, 427
- Костылев С. А., Коджеспирова И. Ф., Шкут В. А. Переключение при локализованном возникновении отрицательного дифференциального сопротивления S -типа. 12, 2184
- Кохановский С. И., Макушенко Ю. М., Сейсян Р. П., Эфрос Ал. Л., Язева Т. В., Абдуллаев М. А. Параметры зонной структуры эпитаксиальных слоев в гетеропереходах $\text{In}_{1-x}\text{Ga}_x\text{As}/\text{InP}$. 3, 493
- Кочка Я., см. Комирченко Р. П. 11, 2034
- Кочелев О. Г., см. Морозова В. А. 9, 1664
- Красильник З. Ф., см. Гавриленко В. И. 4, 718
- Красильник З. Ф., см. Гавриленко В. И. 8, 1315
- Краснопевцев В. В., см. Абрамов В. С. 8, 1355
- Криволапчук В. В., см. Акимов А. В. 4, 713
- Кригель В. Г., см. Деноткин В. Л. 8, 1397
- Круликовская М. П., см. Гроза А. А. 10, 1821
- Крусток Ю. И., Пийбе Т. Э., Лью А. Э. Особенности температурного поведения полосы 0.81 эВ фотолюминесценции теллурида кадмия. 7, 1257
- Крутенюк Ю. В., см. Кольцов Г. И. 2, 245
- Крючков А. Р., см. Ершов В. С. 5, 776
- Крючков С. В. Эволюция параметров солитона в сверхрешетке в процессе ионизации примесей. 3, 568
- Крючков С. В. Увлечение электронов солитонами в сверхрешетке при ионизации примесных центров. 4, 740
- Крючков С. В., Сыродоев Г. А. Влияние термодиффузионной ионизации примесей на проводимость сверхрешетки. 4, 655
- Кудрявцев И. А., см. Балтрамеюнас Р. 2, 271
- Кудряшов Н. А., см. Андреев С. П. 1, 128
- Кудряшов Н. А., Кучеренко С. С. Характеристики полупроводникового диода с резким переходом при высоких уровнях ионизирующих излучений. 7, 1188
- Кузнецов В. В., см. Сорокин В. С. 10, 1818
- Кузнецов В. Д., см. Кульбачинский В. А. 12, 2201
- Кузнецов С. В., см. Казанский А. Г. 8, 1456
- Кузнецов Ю. М., см. Бузанова Е. В. 7, 1121
- Кулешов С. М., см. Воронков В. П. 4, 695
- Куликов Г. С., см. Абдурахманов К. П. 6, 1075
- Куликов Г. С., см. Назыров Д. Э. 9, 1653
- Куликов М. Е., см. Атаев Ж. 8, 1350
- Кулиш Н. Р., см. Булах Б. М. 11, 1946
- Кульбачинский В. А., Свистунов И. В., Чудинов С. М., Кузнецов В. Д., Арушанов Э. П., Захвалинский В. С., Натерев А. Н. Аномалии магнитных и гальваномангнитных свойств разбавленных твердых растворов $(\text{Zn}_{1-x}\text{Mn}_x)_3\text{As}_2$. 12, 2201
- Кульбачинский В. А., см. Абрамов В. В. 3, 513
- Кульбачинский В. А., см. Кадушкин В. И. 4, 612
- Кунькова З. Э., см. Голик Л. Л. 11, 1883
- Курбанов К. Д., см. Григорьев Н. Н. 3, 464
- Курбанов К. Р., см. Григорьев Н. Н. 9, 1649
- Куряева Р. Г., Киркинский В. А., Фурсенко Б. А. Исследование под давлением края полосы поглощения полупроводников в камере с алмазными наковальнями. 6, 1040
- Кусанов О. М., см. Бойков Ю. А. 7, 1246
- Кутасов В. А., см. Бойков Ю. А. 7, 1246
- Кутра И., см. Томашюнас Р. 6, 1070
- Кучова В. З., см. Глазов В. М. 4, 588
- Кучеренко С. С., см. Андреев С. П. 1, 128
- Кучеренко С. С., см. Кудряшов Н. А. 7, 1188
- Кучинский П. В., Ломако В. М., Петрунин А. П. Влияние температуры облучения и электрического поля

- на образование и стабильность вакансионных дефектов в p -Si. 3, 448
- Кучинский П. В., см. Баранов И. А. 1, 73
- Кущимбаева Б. Ш., см. Аверкиев Н. С. 1, 12
- Кютт Р. Н., см. Аверкиев Н. С. 1, 12
- Кязым-заде А. Г., Мехтиева Р. Н., Ахмедов А. А. Сэндвич-фоторезисторы на основе гетеропереходов InSe—GaSe. 8, 1392
- Кязым-заде Р. А., см. Аждаров Г. Х. 4, 760
- Лаврентьева Л. Г., см. Астрова Е. В. 5, 898
- Лагунова Т. С., см. Воронина Т. И. 2, 276
- Лагунова Т. С., см. Воронина Т. И. 2, 283
- Лагунова Т. С., см. Воронина Т. И. 9, 1639
- Лазаренко А. В., см. Чапланов А. М. 3, 417
- Лакеев В. М., см. Акимов Б. А. 2, 250
- Лантратов В. М., см. Винокуров Д. А. 6, 1022
- Ларюшин А. И., см. Гусак Г. М. 3, 369
- Лашкарев Г. В., Бродовой А. В., Радченко М. В., Мисюра И. В. Магнитная восприимчивость и термоэдс узкощелевых полупроводников $Pb_{0.82} \cdot Sn_{0.18}Se$, легированных марганцем. 5, 950
- Лашкевич Е. Г., см. Артамонов В. В. 4, 670
- Лебедев А. А., см. Астрова Е. В. 5, 898
- Лебедев А. А., см. Аникин М. М. 2, 328
- Лебедев А. А., см. Аникин М. М. 3, 479
- Лебедев А. А., см. Абдурахманов К. П. 6, 1075
- Лебедев В. Б., см. Воробьева В. В. 10, 1758
- Левадюк Э. Н., см. Фистуль В. И. 1, 124
- Левандовский В. Г., см. Бузанова Е. В. 7, 1121
- Левинштейн М. Е., Румянцев С. Л. Релаксация фотопроводимости и шум $1/f$ в GaAs, подвергнутом деструктивному сжатию. 1, 164
- Левинштейн М. Е., см. Дьяконова Ю. В. 2, 355
- Левинштейн М. Е., см. Дьяконова Н. В. 12, 2065
- Левит А. Д., см. Георгоблани А. Н. 3, 390
- Леднева Е. С. Спектры фотоэмиссии из металла в p -Ge при низких температурах. 4, 753
- Ленднер М., см. Нятикшис В. 9, 1646
- Леринман Н. К., см. Глузман Н. Г. 1, 121
- Летенко Д. Г., Молодцова Е. В., Пахомов А. В., Поляков А. Я., Попков А. Н., Федорцов А. Б., Чуркин Ю. В. Влияние атомарного водорода на время жизни неравновесных носителей заряда в антимиониде индия. 12, 2132
- Ле Туан, см. Воробьева В. В. 10, 1758
- Либерис Ю., см. Ашмонтас С. 11, 1957
- Лигачев В. А., Филликов В. А. К определению плотности состояний в щели подвижности неупорядоченных полупроводников. 1, 133
- Лигачев В. А., Гордеев В. И., Филиков В. А., Сулемах Х. Конденсация SiH_n -комплексов и псевдолегирование в a -Si : H. 9, 1536
- Лигер В. В. Тиристорный эффект в фоточувствительных структурах n - p - n на PbTe, созданных методом ионной имплантации. 4, 745
- Ликунова В. М., см. Грессеров Б. Н. 5, 807
- Линьков И. Ю., Морозенко Я. В. Наблюдение ультрафиолетовой люминесценции в монокристаллическом SiC-6H. 3, 504
- Лисица М. П., см. Булах Б. М. 11, 1946
- Литвак-Горская Л. Б., см. Гершензон Е. М. 11, 1986
- Литвак-Горская Л. Б., см. Исмагилова Ф. М. 2, 255
- Ляйвин Д. П., см. Ващенко В. А. 7, 1209
- Литвиненко С. В., см. Комиренко Р. П. 11, 2034
- Литовченко В. Г., см. Артамонов В. В. 10, 1704
- Лихобабин Н. П., см. Горобец Н. В. 8, 1453
- Лихолит И. Л., см. Мастеров В. Ф. 8, 1375
- Лифшиц Т. М., см. Андреев Б. А. 5, 880
- Лобов Г. Д., Грацианская Е. И. Экспериментальное наблюдение магнитоэлектрического эффекта в сурьмянистом индии, помещенном в продольное магнитное поле. 9, 1560
- Логвинов Г. Н., см. Гуревич Ю. Г. 5, 792
- Логвинов Г. Н. Электронная температура в неоднородно нагретом полупроводниковом субмикронном слое. 10, 1815
- Ломако В. М., см. Андриевский В. Ф. 2, 222
- Ломако В. М., см. Баранов И. А. 1, 73
- Ломако В. М., см. Козловский В. В. 2, 267
- Ломако В. М., см. Козловский В. В. 3, 545
- Ломако В. М., см. Козловский В. В. 7, 1169
- Ломако В. М., см. Кольченко Т. И. 9, 1574
- Ломако В. М., см. Кучинский П. В. 3, 448
- Лосева С. М., см. Морозова В. А. 9, 1664
- Лубышев Д. И., см. Гусев Г. М. 4, 601
- Лугаков П. Ф., см. Казакевич Л. А. 1, 110
- Луговая Г. Я., см. Исмагилова Ф. М. 2, 255
- Лукин А. Н., см. Сырбу Н. Н. 6, 1067
- Лукин А. Н., см. Сырбу Н. Н. 9, 1542
- Лукьянченко А. И., см. Гергель В. А. 9, 1667

- Лучина В. Г., см. Вывенко О. Ф. 10, 1745
- Лысенко В. А., см. Бродовой Б. А. 4, 624
- Львин В. Э., см. Сырбу Н. Н. 2, 238
- Львин В. Э., см. Сырбу Н. Н. 7, 1136
- Львин В. Э., см. Сырбу Н. Н. 10, 1721
- Львин В. Э., см. Сырбу Н. Н. 10, 1765
- Львова Т. В., см. Берковиц В. Л. 3, 379
- Львова Т. В., см. Берковиц В. Л. 8, 1406
- Лью А. Э., см. Крусток Ю. Й. 7, 1257
- Любин В. М., см. Бедельбаева Г. Е. 2, 197
- Любченко А. В., см. Григорьев Н. Н. 3, 464
- Любченко А. В., см. Григорьев Н. Н. 9, 1649
- Лютович К. Л., см. Буянов А. В. 10, 1711
- Лютович К. Л., см. Васильев В. А. 10, 1833
- Маврин Б. Н., см. Денисов В. Н. 8, 1472
- Магомедов А. Б., см. Даунов М. И. 3, 467
- Магомедов М. А., см. Константинова Н. Н. 11, 2047
- Магомедов М. - Р. А., Абдуллаев М. А., Амирханова Дж. Х. Тепловые и электрические свойства пленок CuInSe_2 , полученные методом испарения из одного или двух источников. 6, 1088
- Мадатов Р. С., см. Аллахвердиев А. М. 1, 177
- Мажирин А. П., см. Качурин Г. А. 4, 596
- Макаренко И. В., см. Берковиц В. Л. 3, 379
- Макаров В. В., см. Кольцов Г. И. 3, 373
- Макарова Т. Л., Шаронова Л. В. Эллипсометрический анализ структуры GaAs -анодный окисел. 11, 1899
- Максименко В. М., см. Бабич В. М. 1, 118
- Максимова С. Я., см. Сарсембинов Ш. Ш. 3, 564
- Макушенко Ю. М., см. Кохановский С. И. 3, 493
- Малик А. И., Грушка Г. Г. Оптоэлектронные свойства гетеропереходов окисел металла-фосфид галлия. 10, 1691
- Малкович Р. Ш., см. Назыров Д. Э. 9, 1653
- Мальвичко Э. А., см. Григорьев Н. Н. 9, 1649
- Малькова Н. В., см. Гоголадзе Д. Т. 3, 475
- Малькова Н. В., см. Соловьева Е. В. 6, 965
- Мальтебасов М. Ж., см. Сарсембинов Ш. Ш. 3, 564
- Малыш Н. И., см. Булах Б. М. 11, 1946
- Малютенко В. К., см. Каплан Б. И. 11, 2011
- Малеренко А. М., см. Баграев Н. Т. 4, 644
- Маматкулов Б. Р., см. Аронов Д. А. 7, 1129
- Маматкулов Б. Р., см. Аронов Д. А. 12, 2228
- Манакон С. М., Сулейменов Б. С., Таурбаев Т. И., Дрюков В. Г. Особенности спектральных характеристик тонкопленочных фотопреобразователей на основе $\alpha\text{-Si}:\text{H}$ с зеркально отражающим тыльным контактом. 9, 1601
- Маренкин С. Ф., см. Морозова В. А. 9, 1664
- Маркаилова М. С., см. Бахадырханов М. К. 11, 1952
- Маркевич В. П., Мурин Л. И. О центрах зарождения термодоноров в кремнии. 2, 262
- Маркевич В. П., Мурин Л. И. Влияние предварительного облучения на образование термодоноров в кремнии. 10, 1737
- Маркевич В. П., см. Борблик В. Л. 8, 1302
- Маркевич И. В., см. Дроздова И. А. 9, 1629
- Масленников Н. М. К вопросу о величине напряжения пробоя $p-n$ -переходов в кремнии. 6, 976
- Мастеров В. Ф., Штельмах К. Ф., Захаренков Л. Ф., Лихолит И. Л., Терлецкий И. А. ЭПР аксиального центра иттербия в InP . 8, 1375
- Мастеров В. Ф., см. Аскеров И. М. 11, 2042
- Мастеров В. Ф., см. Васильев А. Э. 2, 203
- Мастеров В. Ф., см. Георгицэ Е. И. 9, 1589
- Мастеров В. Ф., см. Георгицэ Е. И. 11, 2024
- Мастеров В. Ф., см. Ильин Н. П. 2, 185
- Мастейка Р., см. Томашюнас Р. 6, 1070
- Матвеев Б. А., см. Аверкиев Н. С. 1, 12
- Матвеев М. Н., см. Ионов А. Н. 3, 413
- Матыцън С. В., см. Ершов В. С. 5, 776
- Матяс Э. Е., Гременок В. Ф., Трухан В. М. Оптические свойства пленок $(\text{Zn}_{0.265}\text{Cd}_{0.735})_2(\text{P}_{0.1}\text{As}_{0.9})_2$, полученных импульсным лазерным испарением. 9, 1656
- Махкамов Ш., см. Добровинский Ю. М. 3, 523
- Махний В. П., см. Баранюк В. Ф. 2, 217
- Машовец Т. В., см. Емцев В. В. 1, 45
- Машовец Т. В., см. Емцев В. В. 2, 191
- Мездрогина М. М., см. Голикова О. А. 1, 102
- Мездрогина М. М., см. Голикова О. А. 1, 170
- Мездрогина М. М., см. Голикова О. А. 3, 551
- Мездрогина М. М., см. Голикова О. А. 8, 1448
- Мезенцева М. П., см. Трифонова М. М. 6, 1014
- Мелебаев Д., см. Вигдорович Е. Н. 8, 1419
- Мельник Р. Б., Немов С. А., Житинская М. К., Прошин В. И. Прямые состояния In в твердых растворах $\text{Pb}_{1-x}\text{Sn}_x\text{Se}$. 3, 444
- Мельников А. П., см. Гершензон Е. М. 1, 160

- Мельников С. В., см. Андреев И. А. 8, 1429
- Мельничук С. В., Чернов В. М., Юрийчук И. Н. Характеристики динамички решетки HgTe, CdTe и их твердых растворов. 5, 876
- Мередов М. М., см. Ковалевская Г. Г. 8, 1466
- Меркулов И. А. К теории формы линии горячей фотолюминесценции полупроводников. 2, 351
- Мехтиева Р. Н., см. Кязым-заде А. Г. 8, 1392
- Мигаль В. П., см. Гусев Г. М. 4, 601
- Микуленок А. В., Образцов А. Н., Пирогов В. Г., Стоянова И. Г., Трохин А. С. Исследование методом комбинационного рассеяния света структурного разупорядочения в имплантированном ионами Be^{+} монокристаллах InP. 10, 1805
- Милкович Р. Ш., см. Горнушкина Е. Д. 11, 2044
- Мильвидский М. Г., см. Гоголадзе Д. Т. 3, 475
- Мильвидский М. Г., см. Соловьева Е. В. 6, 965
- Минаждинов М. С., см. Гусаков Г. М. 3, 369
- Миразиан К. М., см. Емцев В. В. 3, 561
- Миргородский В. И., Пешин С. В. О влиянии центров захвата на акустоэлектронное взаимодействие в фотопроводящем сульфиде кадмия. 6, 1004
- Мирзаев А., см. Добровинский Ю. М. 3, 523
- Мирлин Д. Н., см. Заварицкая Э. И. 7, 1263
- Миронов К. Е., см. Баженов Н. Л. 12, 2196
- Миронов К. Е., см. Иванов-Омский В. И. 8, 1423
- Мисюра И. В., см. Лашкарев Г. В. 5, 950
- Митин В. И., см. Добровинский Ю. М. 3, 523
- Михайлов В. И., см. Фистуль В. И. 1, 124
- Михайлова М. П., см. Воронина Т. И. 2, 276
- Михайлова М. П., см. Бреслер М. С. 2, 298
- Михайлова М. П., см. Андреев И. А. 8, 1429
- Мищук О. Н., см. Борковская О. Ю. 3, 487
- Мовилэ В. Ф., см. Георгице Е. И. 1, 41
- Моисеев К. Д., см. Воронина Т. И. 9, 1639
- Моисесенко В. В., см. Киндяк В. В. 9, 1655
- Молдовян Н. А., Радауцян С. И., Тигилян И. М. Спектры комбинационного рассеяния света монокристаллов $ZnAl_{2(1-x)}Ga_{2x}S_4$. 11, 2038
- Молман К.-П., см. Гришечкина С. П. 4, 677
- Молодцова Е. В., см. Летенок Д. Г. 12, 2132
- Молоцкий М. И., Попов Г. Г. Электронное взаимодействие примесей на дислокации. 11, 2014
- Мочка Д., см. Жуковский П. В. 3, 556
- Мороз Н. В., см. Птащенко А. А. 6, 1018
- Мороз С. Е., см. Козловский В. В. 2, 267
- Мороз С. Е., см. Кольченко Т. И. 9, 1574
- Морозенко Я. В., см. Лицьков И. Ю. 3, 504
- Морозова В. А., Пищиков Д. П., Лосева С. М., Кошелев О. Г., Маренки С. Ф. Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллов диарсенида цинка. 9, 1664
- Мохов Е. Н., см. Вавилов В. С. 4, 762
- Мудрый А. В., Патук А. И., Шакин И. А. Образование центров люминесценции в кремнии при низкотемпературной имплантации ионов углерода. 8, 1459
- Мукашев Б. Н., см. Абдуллин Х. А. 4, 684
- Муленков С. Ю., см. Воронков В. П. 4, 695
- Мунтяну Ф. М., см. Гергице Е. И. 9, 1589
- Мурель А. В., см. Алешкин В. Я. 6, 1047
- Мурзин В. Н., см. Заварицкая Э. И. 7, 1263
- Мурин Д. И., см. Калинушкин 5, 798
- Мурин Л. И., см. Маркевич В. П. 2, 262
- Мурин Л. И., см. Маркевич В. П. 10, 1737
- Мусаев А. М. Межподзонное излучение горячих дырок в Ge в сильных $E \perp H$ полях при одноосной упругой деформации. 3, 518
- Муха Л. А., см. Беляев А. Е. 7, 1164
- Мынбаев К. Д., см. Баженов Н. Л. 12, 2196
- Мынбаев К. Д., см. Иванов-Омский В. И. 8, 1423
- Мякейкая Г. С., Гуцев Г. Л., Самойлов В. М. Обобщенная микроскопическая модель аномального мюония и его водородного аналога в кремнии. 6, 970
- Надточий М. Ю., см. Гореленок А. Т. 5, 908
- Назыров Д. Э., Куликов Г. С., Малкович Р. Ш. Диффузия эрбия и тулия в кремнии. 9, 1653
- Натепров А. Н., см. Кульбачинский В. А. 12, 2201
- Неврюева Е. Н., см. Домашевская Э. П. 5, 893
- Неймаш В. Б., Саган Т. Р., Цмоць В. М., Шаховцов В. И., Шиндич В. Л. О некоторых механизмах влияния тепловой предыстории на поведение параметров кремния под облучением. 11, 1857
- Неймаш В. Б., Саган Т. Р., Цмоць В. М., Шаховцов В. И., Шиндич В. Л., Штым В. С. Магнитное упорядочение кислородосодержащих термодоноров в кремнии. 11, 1864
- Нейфельд Э. А., Доманская Л. И., Городилова Н. А. Влияние одноосного сжатия на термоэде увлечения в p -InSb. 8, 1463
- Нелуц В. А., см. Бродовой В. А. 4, 624
- Немиш И. Ю., см. Ионов А. Н. 3, 413

- Немов С. А., Житинская М. К., Прошин В. И. Особенности механизма самокомпенсации легирующего действия примеси хлора в PbSe. 1, 114
- Немов С. А., Житинская М. К., Прошин В. И. Особенности явлений переносов в PbTe, легированном одновременно Ti и Si. 6, 979
- Немов С. А., Житинская М. К., Прошин В. И. Особенности компенсации легирующего действия донорных примесей вакансиями в $Pb_{0.93}Sn_{0.07}Se$. 9, 1634
- Немов С. А., см. Выдрик В. Н. 1, 106
- Немов С. А., см. Мельник Р. Б. 3, 444
- Несмелова И. М. Поглощение света в компенсированных полупроводниках с кейновской зонной структурой. 12, 2215
- Нечипорук Б. Д., см. Артамонов В. В. 4, 670
- Нечипорук Б. Д., см. Артамонов В. В. 10, 1704
- Никитин В. Г., см. Брунков П. Н. 2, 338
- Никитин Л. П., см. Зимогорова Н. С. 7, 1253
- Никоноров В. В., см. Гавриленко В. И. 4, 718
- Никоноров В. В., см. Гавриленко В. И. 8, 1315
- Никорич А. В., см. Акимов Б. А. 2, 250
- Нифтьев Г. М., Тагиев О. Б., Зейналов Э. З., Алиев Б. Д. Оптические свойства монокристаллов $MnGa_2Se_4$. 4, 704
- Новиков Е. Б., см. Берковиц В. Л. 8, 1406
- Новиков С. В., см. Денисов В. Н. 8, 1472
- Новиков С. В., см. Воробьева В. В. 10, 1758
- Новикова В. М., см. Гоголадзе Д. Т. 3, 475
- Новикова В. М., см. Соловьева Е. В. 6, 965
- Норейка Д., см. Пятраускас М. 2, 344
- Норейка Д., см. Нятикшис В. 9, 1646
- Нятикшис В., Норейка Д., Пятраускас М., Йодказис С., Ленцнер М. Особенности динамики неравновесных носителей заряда ННЗ в кристаллах GaAs при сильном оптическом возбуждении. 9, 1646
- Нятикшис В., см. Балтрамеюнас Р. 4, 736
- Нятикшис В., см. Пятраускас М. 2, 344
- Образцов А. Н., см. Микуленок А. В. 10, 1805
- Обрехт М. С., см. Бобрикова О. В. 5, 828
- Овчинников А. В., см. Гарбузов Д. З. 5, 928
- Овчинников А. В., см. Гарбузов Д. З. 8, 1414
- Оджаёв В. Б., см. Аль-Баккур Ф. 10, 1841
- Одинцов А. А. Одноэлектронный транспорт в системе с управляемой прозрачностью туннельных барьеров. 8, 1297
- Олешко Е. В., Велиюлин Э. И., Козыренко В. Н., Кахрама-нов С. Ш. Особенности изменения электронной структуры теллурида висмута при самоинтеркаляции медью. 6, 1073
- Олиференко Н. М., см. Сырбу Н. Н. 6, 1067
- Онаркулов К. Э., см. Атакулов Ш. Б. 4, 633
- Осипов В. В., см. Ващенко В. А. 7, 1209
- Осипов В. В., см. Гафийчук В. В. 10, 1696
- Осипов Е. Б., см. Аверкиев Н. С. 1, 50
- Осипов Е. Б., см. Аверкиев Н. С. 1, 58
- Осипов Е. Б., см. Аверкиев Н. С. 11, 1967
- Осипов Е. Б., см. Аверкиев Н. С. 11, 1976
- Осипов Е. Б., см. Климакова Н. Н. 3, 558
- Осипова А. Н., см. Соловьева Е. В. 6, 965
- Осипова Н. А., см. Климакова Н. Н. 3, 558
- Остриков К. Н., см. Азаренков Н. А. 8, 1344
- Павлов А. М., см. Фистуль В. И. 1, 124
- Павловец М. В., см. Чапланов А. М. 3, 417
- Пакальнис С., см. Балтрамеюнас Р. 2, 271
- Памяти Павла Михайловича Карагеоргия-Алкалаева. 7, 1277
- Панасюк В. М., см. Бузанова Е. В. 7, 1121
- Панасюк Л. И., см. Ермаков Е. Н. 1, 179
- Панахов М. М., см. Бычковский Д. Н. 4, 660
- Панахов М. М., см. Бычковский Д. Н. 11, 1889
- Паносян Ж. Р., Касаманян З. А., Шмавонян Г. Ш. Размерно-квантованные поверхностные экситоны на границе раздела CdTe—электролит. 6, 1030
- Панфилова С. В., см. Чайка Г. Е. 2, 336
- Папанцев М. И., см. Брунков П. Н. 2, 338
- Паранчич С. Ю., см. Глузман Н. Г. 1, 121
- Паранчич Ю. С., см. Глузман Н. Г. 1, 121
- Парманкулов И. П., см. Бахадырханов М. К. 10, 1731
- Парфенюк О. А., см. Бейсюк П. П. 6, 961
- Патук А. И., см. Мудрый А. В. 8, 1459
- Пахомов А. А., см. Абакумов В. Н. 9, 1489
- Пахомов А. В., см. Летенко Д. Г. 12, 2132
- Пашабекова У. С., см. Гашимзаде Н. Ф. 12, 2217
- Папаев Э. М., Капевский В. М., Пурцхванидзе А. А., Перегудов В. Н. Влияние рентгеновского излучения на реальную структуру кристаллов $Cd_xHg_{1-x}Te$. 6, 1080
- Пашковский А. Б. Поперечный пространственный перенос электронов в структурах металл— $In_{0.52}Al_{0.48}As/In_{0.53}Ga_{0.47}As$ и металл— $Al_xGa_{1-x}As/$

- $\text{In}_x\text{Ga}_{1-y}\text{As}/\text{GaAs}$ с селективным легированием в сильном электрическом поле. 12, 2179.
- Пашковский А. Б., см. Ершов В. С. 5, 776
- Пашук А. В., см. Денисов В. П. 8, 1381
- Пека Г. П., Россохатый В. К., Смоляр А. Н. Влияние переизлучения на время переключения длинного диода с варизонной базой. 12, 2126
- Пека Г. П., см. Буянов А. В. 10, 1711
- Пенин Н. А. Оптическая и тепловая стимуляция примесной фотопроводимости при оптическом возбуждении примесных атомов в полупроводниках. 11, 1941
- Пенцов А. В., см. Андрушко А. И. 10, 1686
- Пенцов А. В., см. Ковалевская Г. Г. 8, 1466
- Перегудов В. Н., см. Пашаев Э. М. 6, 1080
- Перенелкин А. Д., Яфясов А. М., Божевольнов В. Б. Исследование электрофизических параметров ОПЗ узкощелевых полупроводников $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$ методом эффекта поля в электролите. 4, 156
- Перенелкин А. Д., см. Яфясов А. М. 4, 748
- Перенелкин А. Д., см. Яфясов А. М. 8, 1339
- Пермогоров С. А., см. Заварицкая Э. И. 7, 1263
- Петров В. В., см. Аль-Бакур Ф. 10, 1841
- Петров И. Н., см. Голикова О. А. 1, 170
- Петросян П. Г., см. Варданян Г. А. 2, 295
- Петросян П. Г., см. Вуль А. Я. 10, 1718
- Петрунин А. П., см. Баранов И. А. 1, 73
- Петрунин А. П., см. Кучинский П. В. 3, 448
- Пешин С. В., см. Миргородский В. И. 6, 1004
- Пиштейн Т. Э., см. Крусток Ю. Й. 7, 1257
- Пикус Г. Е., см. Заварицкая Э. И. 7, 1263
- Пикус Ф. Г. Максимальная низкотемпературная подвижность двумерного электронного газа в гетероструктурах с широким спейсерным слоем. Моделирование на ЭВМ. 4, 729
- Пирогов В. Г., см. Микуленок А. В. 10, 1805
- Пихтин Н. А., см. Гарбузов Д. З. 5, 928
- Пихтин Н. А., см. Гарбузов Д. З. 8, 1414
- Пищиков Д. И., см. Морозова В. А. 9, 1664
- Пляцко С. В., Громовой Ю. С., Костюнин Г. Е. ЭПР и электрофизические свойства монокристаллических слоев $\text{PbTe}:\text{Mn}$, выращенных методом лазерной эпитаксии. 3, 427
- Пляцко С. В., см. Громовой Ю. С. 6, 1083
- Погорлецкий В. М., см. Георгицэ Е. И. 7, 1217
- Погосов А. Г., см. Гусев Г. М. 4, 601
- Погосов А. Г., см. Квон З. Д. 1, 138
- Покутний С. И. Размерное квантование электронно-дырочной пары в квазиультимерных полупроводниковых структурах. 4, 628
- Полетаев Н. К., см. Акимов А. В. 4, 713
- Полоскин Д. С., см. Емцев В. В. 2, 191
- Полторацкий Э. А., см. Гергель В. А. 9, 1667
- Полторацкий Э. А., см. Гергель В. А. 11, 1870
- Полунин В. А., см. Андреев С. И. 1, 128
- Полыгалов Ю. П., см. Басалаев Ю. М. 5, 952
- Поляков А. Я., см. Летенко Д. Г. 12, 2132
- Полянская Т. А., см. Воробьева В. В. 10, 1758
- Понарина В. П., см. Спирин А. И. 1, 173
- Пономарева О. А., см. Кольченко Т. И. 9, 1574
- Поплавной А. С., см. Басалаев Ю. М. 5, 952
- Полков А. Н., см. Летенко Д. Г. 12, 2132
- Полов А. М., см. Волкова Е. А. 9, 1618
- Попов Г. Г., см. Молоцкий М. И. 11, 2014
- Попов М. В., см. Кардо-Сысоев А. Ф. 1, 3
- Попова Г. Д., см. Бузанова Е. В. 7, 1121
- Попова Т. Б., см. Воронина Т. И. 9, 1639
- Поповичева О. Б., см. Волкова Е. А. 9, 1618
- Портной М. Е. Анизотропия линейной поляризации фотолюминесценции горячих электронов в квантовых ямах. 12, 2150
- Поссе Е. А., см. Гольдберг Ю. А. 3, 439
- Приходько Е. Л., см. Айвазов А. А. 10, 1802
- Приходько О. Ю., см. Сарсембинов Ш. Ш. 3, 564
- Прокопова Т. В., см. Сысоев Б. И. 4, 699
- Прокфьева Н. А., см. Воронина Т. И. 9, 1639
- Прохорович А. В., см. Винник Е. В. 1, 82
- Просолович В. С., см. Аль-Бакур Ф. 10, 1841
- Прошин В. И., см. Мельник Р. Б. 3, 444
- Прошин В. И., см. Немов С. А. 1, 114
- Прошин В. И., см. Немов С. А. 6, 979
- Прошин В. И., см. Немов С. А. 9, 1634
- Птаченко А. А., Мороз Н. В., Будулак В. И. О возможном механизме появления отрицательного сопротивления $p-n$ -гетеропереходов с глубокими уровнями. 6, 1018
- Пузин И. Б. Об определении концентрации легирующей примеси в активном слое ДГС лазеров из емкостных измерений. 6, 1007
- Пурцхванидзе А. А., см. Пашаев Э. М. 6, 1080
- Пятко С. Н., см. Аникин М. М. 2, 328
- Пятраускас М., Норейка Д., Нятикшис В., Банайтис А. Некоторые особенности динамики NH_3 в кристаллах кремния при сильном оптическом возбуждении. 2, 344

- Пятраускас М., см. Балтрамеюнас Р. 4, 736
- Пятраускас М., см. Нятикшис В. 9, 1646
- Пятраускас М., см. Томашюнас Р. 6, 1034
- Пятраускас М., см. Томашюнас Р. 6, 1070
- Рабизо О. В., см. Выдрик В. Н. 1, 106
- Рагимова Н. А., см. Джафарова С. З. 6, 983
- Радауцян С. И., см. Молдовян Н. А. 11, 2038
- Радевич Е. И., см. Слободян В. З. 5, 919
- Радченко М. В., см. Лашкарев Г. В. 5, 950
- Райчев О. Э. Исправления к статье «Особенности проводимости ГХ-сверхрешеток». 10, 1845
- Райчев О. Э. Особенности проводимости ГХ-сверхрешеток. 7, 1228
- Райчев О. Э. Проводимость сверхрешеток с узкими минизонами в квантующих магнитных полях. 9, 1547
- Райчев О. Э., см. Грибников З. С. 5, 859
- Раренко И. М., см. Бабенцов Б. Н. 7, 1243
- Раренко И. М., см. Баранский П. И. 7, 1183
- Раренко И. М., см. Гарягдыев Г. З. 409
- Растегаева М. Г., см. Аникин М. М. 2, 328
- Рассулов Н. Л., см. Гарбузов Д. З. 8, 1414
- Рахманкулов М. Х., см. Атакулов Ш. Б. 4, 633
- Рачюкайтис Г., см. Рыжиков В. Д. 5, 841
- Рашевская Е. П., см. Белогорохов А. И. 7, 1196
- Рашидова Ш. Ш., см. Алиев М. И. 11, 2054
- Рашковецкий Л. В., см. Бабенцов В. Н. 4, 756
- Регель А. Р., см. Глазов В. М. 4, 588
- Резников Б. И., Царенков Г. В. Спектральная фоточувствительность m -структуры. 11, 1922
- Ремесник В. Г., Талипов Н. Х. О концентрации и подвижности электронов в узкозонных полупроводниковых соединениях $A^{III}B^{VI}$ p -типа. 6, 1091
- Ремизов О. А., см. Бабицкий Ю. М. 5, 838
- Рехвиашвили Д. Н., см. Гореленок А. Т. 5, 908
- Решиков М. А., см. Аверкиев Н. С. 1, 50
- Решиков М. А., см. Аверкиев Н. С. 1, 58
- Ржевкин К. С., см. Аитов Р. Д. 5, 904
- Родина А. В., см. Гельмонт Б. Л. 12, 2189
- Родионов А. В., см. Гергель В. А. 11, 1870
- Родионов В. Е., см. Ермаков Е. Н. 1, 179
- Родригес Х.-А., см. Гучмазов А. Б. 1, 143
- Роенков А. Д., см. Вавилов В. С. 4, 762
- Роенков А. Д., см. Ващенко В. А. 7, 1209
- Ройзин Я. О., Цыбесков Л. В. Роль водорода в формировании и стабильности границы раздела кристаллический кремний—аморфный гидрированный кремний. 3, 422
- Романов Ю. А., см. Алешкин В. Я. 6, 1047
- Романюк Б. Н., см. Артамонов В. В. 10, 1704
- Россохатый В. К., см. Пека Г. П. 12, 2126
- Рудь В. Ю., Рудь Ю. В., Таиров М. А. Компенсация фотоплекроизма полляриметрических структур на основе $CdGeP_2$. 8, 1469
- Рудь В. Ю., см. Константинова Н. Н. 11, 2047
- Рудь Ю. В., см. Константинова Н. Н. 11, 2047
- Рудь Ю. В., см. Рудь В. Ю. 8, 1469
- Румянцев В. Д., см. Гучмазов А. Б. 1, 143
- Румянцев С. Л., см. Дьяконова Н. В. 2, 355
- Румянцев С. Л., см. Дьяконова Н. В. 12, 2065
- Румянцев С. Л., см. Левинштейн М. Е. 1, 164
- Руснак Н. И., см. Бейсюк П. П. 6, 961
- Руссу Е. В., см. Ковалевская Г. Г. 8, 1466
- Рыжий В. И., Хмырова И. И. Неоднозначность вольт-амперных характеристик биполярных гетеротранзисторов с туннельно-резонансным эмиттером. 4, 637
- Рыжий В. И., см. Захарова А. А. 3, 402
- Рыжиков В. Д., Гаврюшин В. И., Казлаускас А., Рачюкайтис Г. Влияние термообработки на формирование центров рекомбинации в изovalентно легированных кристаллах $ZnSe(Te)$. 5, 841
- Рыжиков В. Д., см. Вакуленко О. В. 6, 1053
- Рыльков В. В., см. Дмитриев С. Г. 2, 360
- Рытова Н. С. Анализ диффузионных профилей водорода, образующихся при гидrogenизации полупроводниковых образцов. 6, 990
- Рытова Н. С. Образование молекул водорода в арсениде галлия n -типа при его гидrogenизации. 6, 1078
- Рытова Н. С. О пассивации электрически активных центров в полупроводниках нейтральным атомарным водородом. 2, 316
- Рябова Л. И., см. Акимов Б. А. 2, 250
- Рябова Л. И., см. Акимов Б. А. 2, 342
- Сабирзянова Л. Д., см. Глузман Н. Г. 1, 121
- Савельев И. Г., см. Воробьева В. В. 10, 1758
- Савицкий А. В., см. Бейсюк П. П. 6, 961
- Савкина Н. С., см. Аникин М. М. 2, 328
- Сагант Р., см. Неймаш В. Б. 11, 1857
- Сагант Р., см. Неймаш В. Б. 11, 1864
- Садюфьев Ю. Г., см. Артамонов В. В. 4, 670

- Сазонов А. Ю., см. Айвазов А. А. 10, 1802
- Сайдашев И. И., см. Вуль А. Я. 10, 1718
- Салихов Х. М., см. Андрушко А. И. 10, 1686
- Салихов Х. М., см. Ковалевская Г. Г. 8, 1466
- Самойлов В. М., см. Мякенькая Г. С. 6, 970
- Саморуков Б. Е., Сиповская М. А., Сяврис Е. А., Тихомирова В. В. Поведение иттербия в эпитаксиальных слоях р-GaInSbAs. 10, 1830
- Санкин В. И., см. Ващенко В. А. 7, 1209
- Сарсембинов Ш. Ш., Приходько О. Ю., Мальтекбасов М. Ж., Максимова С. Я., Аверьянов В. Л. Биполярная фотопроводимость в аморфных пленках As_2Se_3 . 3, 564
- Сафаралиев Г. К., Таиров Ю. М., Цветков В. Ф. Широкозонные твердые растворы $(SiC)_{1-x}(AlN)_x$. 8, 1437
- Сафаров В. И., см. Амальская Р. М. 3, 529
- Сафаров В. И., см. Берковиц В. Л. 3, 379
- Сафаров В. И., см. Берковиц В. Л. 8, 1406
- Сафронов Е. Ю., Синявский Э. П. Лазерно-индуцированное поглощение звука в полупроводниках в квантующем магнитном поле. 5, 943
- Свердлова А. М., см. Кабанов В. Ф. 8, 1388
- Свечников Т. Е., см. Коржуев М. А. 12, 2141
- Свиридов В. В., см. Белявский В. И. 7, 1204
- Свистанов И. В., см. Кульбачинский В. А. 12, 2201
- Седов В. Е., см. Аверкиев Н. С. 1, 50
- Седов В. Е., см. Аверкиев Н. С. 1, 58
- Седов В. Е., см. Аверкиев Н. С. 11, 1967
- Седов В. Е., см. Аверкиев Н. С. 11, 1976
- Седов В. Е., см. Гуткин А. А. 3, 508
- Сейсян Р. П., см. Кохановский С. И. 3, 493
- Селезнев А. Е., см. Спириг А. И. 1, 173
- Селин С. М., см. Тиман Б. Л. 6, 1107
- Семенюк Ю. А., Шаховцова С. И., Белокурова И. Н. Низкотемпературный примесный пробой в одноосно деформированных сплавах германий—кремний. 9, 1553
- Сергеев С. О., см. Булах Б. М. 11, 1946
- Сергеева В. В., см. Кольченко Т. И. 9, 1574
- Сердга Б. К., см. Зыков В. Г. 12, 2173
- Серженко Ф. Л., Шадрин В. Д. Теория фотоэлектрических и пороговых характеристик фотоприемников на основе многослойных структур GaAs—AlGaAs с квантовыми ямами. 9, 1579
- Сизов Ф. Ф., Громовой Ю. С. Магнитоплазменные волны в многодолинных узкощелевых полупроводниках $Al_0.53Ga_{0.47}As$. 12, 2158
- Сизов Ф. Ф., см. Гуменюк-Сычевская Ж. В. 5, 913
- Сидицын М. А., см. Винокуров Д. А. 6, 1022
- Син Сюй, Ван Си-фу. Новый метод экспериментальной проверки модели инверсионного слоя аномального эффекта Холла при комнатной температуре. 4, 577
- Синюс Я., см. Томашюнас Р. 6, 1034
- Синявский Э. П., см. Сафронов Е. Ю. 5, 943
- Сиповская М. А., см. Воронина Т. И. 2, 276
- Сиповская М. А., см. Воронина Т. И. 9, 1639
- Сиповская М. А., см. Саморуков Б. Е. 10, 1830
- Сирота А. В., см. Грицюк Б. Н. 12, 2135
- Скайстис Э., см. Балтрамеюнас Р. 4, 736
- Скрышевский В. А., см. Воробьев Ю. В. 2, 334
- Скрышевский В. А., см. Комиренко Р. П. 11, 2034
- Слободчиков С. В., см. Андрушко А. И. 10, 1686
- Слободчиков С. В., см. Ковалевская Г. Г. 8, 1466
- Слободянов В. З., Радевич Е. И., Гавалешко Н. П. Электронная структура и степень ионности алмазоподобных полупроводников в приближении метода кристаллических функций компонентов. 5, 919
- Слынько В. В., Слынько Е. И., Хандожко А. Г., Выграненко Ю. К., Данилюк Г. В. Обнаружение магнитоупорядоченных кластеров в полумагнитных полупроводниках. 10, 1836
- Слынько Е. И., см. Слынько В. В. 10, 1836
- Смирнов В. А., см. Баженов Н. Л. 6, 1103
- Смирнов В. А., см. Белотелов С. В. 6, 1058
- Смирнов В. А., см. Георгицэ Е. И. 7, 1217
- Смирнов В. А., см. Георгицэ Е. И. 11, 1960
- Смирнов В. А., см. Георгицэ Е. И. 11, 2024
- Смирнов Н. А., см. Аверкиев Н. С. 11, 1976
- Смоляр А. Н., см. Пека Г. П. 12, 2126
- Сморчкова Ю. П., см. Андреев П. А. 8, 1429
- Снигур А. П., см. Сырбу Н. Н. 7, 1146
- Соболев М. М., см. Брунков П. Н. 2, 338
- Соболев Н. А., см. Выжигин Ю. В. 8, 1324
- Соболев Н. А., см. Грессеров Б. Н. 5, 807
- Соколова З. Н., см. Гарбузов Д. З. 5, 928
- Соловьева Е. В., Мильвидский М. Г., Белогорохов А. И., Виноградова Г. И., Гоголадзе Д. Т., Долгинов Л. М., Малькова Н. В., Новикова В. М., Осипова А. Н. Влияние фазовых превращений на оптические и электрические свойства эпитаксиальных гетероструктур $In_{0.53}Ga_{0.47}As/InP$. 6, 965
- Соловьева Е. В., см. Гоголадзе Д. Т. 3, 475

- Соломонов А. В., см. Зубков В. И. 12, 2163
- Соломонов А. И., см. Иващенко А. И. 9, 1658
- Сотников А. Н., см. Гергель В. А. 9, 1667
- Сорокин В. С., Кузнецов В. В. Влияние плоской упругой деформации на ширину запрещенной зоны твердых растворов $Ga_{0,5}In_{0,5}P$. 10, 1818
- Сорокина К. Л., см. Голикова О. А. 8, 1448
- Сосновский В. Д., см. Аверкиев Н. С. 1, 50
- Сосновский В. Р., см. Аверкиев Н. С. 1, 58
- Сохацкий А. С., см. Аль-Баккур Ф. 10, 1841
- Спирин А. И., Понарина В. И., Бендюгов В. Е., Захаров Ю. В., Селезнев А. Е., Кириллов В. И. О связи пиков фотoluminesценции и ИК поглощения в $\alpha-Si$: Н. 4, 173
- Сресели О. М., см. Беляков Л. В. 8, 1281
- Стась В. Ф., см. Бобрикова О. В. 5, 828
- Стамов И. Г., см. Сырбу Н. Н. 12, 2115
- Становов О. Н., см. Айвазов А. А. 10, 1808
- Стариков Е. В., см. Гавриленко В. И. 4, 718
- Стариков Е. В., см. Гавриленко В. И. 8, 1315
- Старчик М. И., см. Гроза А. А. 10, 1821
- Стельмах В. Ф., см. Жуковский П. В. 3, 556
- Степанов А. С., см. Бедный Б. И. 8, 1450
- Стойнова И. Г., см. Микуленок А. В. 10, 1805
- Стратан Г. И., см. Сырбу Н. Н. 5, 783
- Стрельчук А. М., см. Аникин М. М. 2, 328
- Стрельчук А. П., см. Аникин М. М. 3, 479
- Стриха В. И., см. Воробьев Ю. В. 2, 334
- Стриха В. И., см. Комиренко Р. П. 11, 2034
- Строкан Н. Б., см. Вербицкая Е. М. 5, 852
- Стряхилев Д. А., см. Айвазов А. А. 11, 2040
- Стусь Н. М., см. Аверкиев Н. С. 1, 12
- Стухлик И., см. Комиренко Р. П. 11, 2034
- Стучинский В. А., см. Болотов В. В. 4, 723
- Стучинский В. А., см. Болотов В. В. 12, 2168
- Субачюс Л., см. Ашмонтас С. 11, 1957
- Субашиев А. В., см. Герчиков Л. Г. 2, 231
- Сулейманов Б. С., см. Манаков С. М. 9, 1601
- Сулеман Х., см. Лигачев В. А. 9, 1536
- Супруненко В. Н., см. Вакуленко О. В. 6, 1053
- Сур И. В., см. Касиян А. И. 4, 689
- Сурис Р. А., см. Гольдин А. А. 5, 934
- Сурис Р. А., см. Заварицкая Э. И. 7, 1263
- Суханов В. Л., см. Баграев Н. Т. 4, 644
- Суханов В. Л., см. Баграев Н. Т. 9, 1613
- Сырбу Н. Н., Заднипру И. Б., Тэзлован В. Е. Колебательные спектры и эффективные заряды в шпинелях In_2S_3 , $CdIn_2S_4$, $AgIn_5S_8$ и $CuIn_3S_8$. 8, 1366
- Сырбу Н. Н., Луккин А. Н., Заднипру И. Б. ИК колебательные спектры GeP . 9, 1542
- Сырбу Н. Н., Львин В. Э. Инфракрасные колебательные моды и характер химической связи в кристаллах ZnP_2 и CdP_2 . 7, 1136
- Сырбу Н. Н., Львин В. Э. Рассеяние света оптическими фонами в тетрагональных кристаллах ZnP_2 . 10, 1765
- Сырбу Н. Н., Львин В. Э. Спектры комбинационного рассеяния света дифосфида кадмия вблизи фазовых переходов второго рода. 2, 238
- Сырбу Н. Н., Львин В. Э., Заднипру И. Б., Головей В. М. Рамановские и инфракрасные колебательные спектры кристаллов $PbGa_2S_4$. 10, 1721
- Сырбу Н. Н., Снигур А. П., Чумаков В. А., Хачатурова С. Б. Плазмон-фононные моды и непараболичность зоны проводимости в эпитаксиальных слоях $InGaAs/InP$. 7, 1146
- Сырбу Н. Н., Стамов И. Г. Фотопримечки линейно поляризованного излучения. 12, 2115
- Сырбу Н. Н., Хачатурова С. Б., Заднипру И. Б., Стратан Г. И. Инфракрасные колебательные моды в кристаллах моноклинной модификации ZnP_2 , $ZnAs_2$ и CdP_4 . 5, 783
- Сырбу Н. Н., Хачатурова С. Б., Олиференко Н. М., Бурка А., Луккин А. Н. Колебательные ИК спектры $SiAs$. 6, 1067
- Сыркин А. Л., см. Аникин М. М. 2, 328
- Сырродоев Г. А., см. Крючков С. В. 4, 655
- Сысоев Б. И., Агапов Б. Л., Безрядин Н. Н., Буданов А. В., Прокопова Т. В., Фетисова С. В. Свойства границы раздела $InAs$ —тонкий полупроводящий слой In_2S_4 . 4, 699
- Сысоев Б. И., Антюшин В. Ф., Кипнис М. М. Резистивно-емкостные МДП структуры с сильной зарядовой связью по обогащенному слою. 4, 708
- Сычуглов В. А., см. Авруцкий И. А. 10, 1787
- Сяврис Е. А., см. Саморуков Б. Е. 10, 1830
- Тагиев Б. Г., Тагиев О. Б., Касимова Г. А. Инжекционные токи и термополевой эффект Пула—Френкеля в монокристаллах твердых растворов $(Ga_2S_3)_{1-x}(Eu_2O_3)_x$. 11, 1977
- Тагиев Б. Г., см. Аскеров И. М. 11, 2042
- Тагиев О. Б., см. Нифтиев Г. М. 4, 704
- Тагиев О. Б., см. Тагиев Б. Г. 11, 1877
- Таиров М. А., см. Рудь В. Ю. 8, 1469
- Таиров Юрий Михайлович (к 60-летию со дня рождения). 11, 2055
- Таиров Ю. М., см. Сафаралиев Г. К. 8, 1437

- Талалакин Г. Н., см. Аверкиев Н. С. 1, 12
- Талипов Н. Х., см. Ремесник В. Г. 6, 1091
- Тамендаров М. Ф., см. Абдуллин Х. А. 4, 684
- Тамм М. Е., см. Акимов Б. А. 2, 342
- Тамулайтис Г., см. Балтрамеюнас Р. 2, 271
- Таран Ю. Н., см. Глазов В. М. 4, 588
- Тарасов И. С., см. Гарбузов Д. З. 5, 928
- Тарасов И. С., см. Гарбузов Д. З. 8, 1414
- Тарнавский С. П., см. Гергель В. А. 11, 1870
- Тарченко В. П., см. Иващенко А. И. 9, 1658
- Таурбаев Т. И., см. Манаков С. М. 9, 1601
- Терехов А. С., см. Журавлев К. С. 10, 1811
- Терехов В. А., см. Голикова О. А. 8, 1448
- Терехов В. А., см. Домашевская Э. П. 5, 893
- Терлецкий И. А., см. Мастеров В. Ф. 8, 1375
- Тер-Мартirosян А. Л., см. Карпов С. Ю. 8, 1361
- Теруков Е. И., см. Атаев Ж. 8, 1350
- Тетеркина И. В., см. Астрова Е. В. 5, 898
- Тигляню И. М., см. Молдовян Н. А. 11, 2038
- Тиман Б. Л., Карпова А. П., Селин С. М. Изменение свойств контакта в процессе протекания тока в системе $\text{In}-\text{CdS}-\text{In}$. * 6, 1107
- Тимофеев А. Б., см. Абрамов В. В. 3, 513
- Тимофеев В. Б., см. Заварицкая Э. И. 7, 1263
- Тимошина Г. Г., см. Глазов В. М. 4, 588
- Тихов С. В., Касаткин А. П., Карпович С. И. Влияние токов утечки через изолятор на поведение МДП структур. 3, 434
- Тиходеев С. Г., см. Заварицкая Э. И. 7, 1263
- Тиходеев Ю. С., см. Караваев Г. Ф. 7, 1237
- Тихомирова В. В., см. Саморуков Б. Е. 10, 1830
- Ткачев С. Н., см. Антов Р. Д. 5, 904
- Ткаченко В. Н., см. Буянов А. В. 10, 1711
- Тодуа П. А., см. Знаменский Д. А. 12, 2219
- Томашюнас Р., Мастейка Р., Пятраускас М., Жиндулис А., Кутра Й. Фотопроводимость сильно возбужденных поликристаллических пленок CdTe . 6, 1070
- Томашюнас Р., Пятраускас М., Вайткус Ю., Сигис Я., Гапка Р., Власкин А. Фотопроводимость в пленках PbS при возбуждении наносекундными импульсами света. 6, 1034
- Травков И. В., см. Гуртов В. А. 3, 385
- Трифонова М. М., Барышев Н. С., Мезенцева М. П. Электрические свойства эпитаксиальных слоев марганец—ртуть—теллур n -типа. 6, 1014
- Тростянский С. Н., см. Голикова О. А. 8, 1448
- Трофимов И. Е., см. Исмаилова Ф. М. 2, 255
- Трохин А. С., см. Микуленок А. В. 10, 1805
- Трухан В. М., см. Матяс Э. Е. 9, 1656
- Турбеков У. Ш., см. Вербицкая Е. М. 5, 852
- Турсунов Н. А., см. Добровинский Ю. М. 3, 523
- Тысченко И. Е., см. Александров Л. Н. 2, 227
- Тысченко И. Е., см. Качурин Г. А. 4, 596
- Тэлован В. Е., см. Сырбу Н. Н. 8, 1366
- Узлов К. И., см. Глазов В. М. 4, 588
- Улин В. П., см. Винокуров Д. А. 6, 1022
- Ульяшин Ф. Г., см. Абрамов В. В. 3, 513
- Усиевич Б. А., см. Авруцкий И. А. 10, 1787
- Устинов В. М., см. Гореленок А. Т. 5, 908
- Утамурадова Ш. Б., см. Абдурахманов К. Т. 6, 1075
- Уханов Ю. И., см. Джумамухамбетов Н. Г. 1, 168
- Фалеев Н. Н., см. Винокуров Д. А. 6, 1022
- Фалькевич Э. С., см. Глазов В. М. 4, 588
- Федина Л. И., см. Асеев А. Л. 582
- Федина Л. И., см. Качурин Г. А. 4, 596
- Федирко В. Б., Захарова А. А. Релаксация горячих электронов на равновесных флуктуациях плотности дырочной плазмы. 9, 1607
- Федоренко А. В., см. Гергель В. А. 11, 1870
- Федоров А. В., см. Гуревич С. А. 5, 769
- Федоров Ю. Ю., см. Ершов В. С. 5, 776
- Федорова О. М., см. Винокурова Д. А. 6, 1022
- Федорович А. Е., см. Гуревич С. А. 5, 769
- Федорцов А. Б., см. Летенко Д. Г. 12, 2132
- Федосеева Н. В., см. Бедный Б. И. 8, 1450
- Фетисова С. В., см. Сысоев Б. И. 4, 699
- Филиков В. А., см. Лигачев В. А. 1, 133
- Филиков В. А., см. Лигачев В. А. 9, 1536
- Фикуль В. И., Павлов А. М., Левадюк Э. Н., Михайлов В. И. Состояние лазерно-имплантированного кремния на границе $\text{Si}-\text{Al}$. 1, 124
- Фикуль В. И., см. Емцев В. В. 6, 997
- Фридрих Е. С., см. Гасан-заде С. Г. 5, 871
- Фукс Б. И., см. Винокуров Д. А. 11, 2003

- Фурсенко Б. А., см. Куряева Р. Г. 6, 1040
- Халамейда Д. Д., см. Грицок Б. Н. 12, 2135
- Халфин В. Б., см. Гарбузов Д. З. 5, 928
- Хамидов А., см. Бахадырханов М. К. 10, 1731
- Хандожко А. Г., см. Слынько В. В. 10, 1836
- Хасиева Р. В., см. Берковиц В. Л. 3, 379
- Хасиева Р. В., см. Берковиц В. Л. 8, 1406
- Хачатурова С. Б., см. Сырбу Н. Н. 5, 783
- Хачатурова С. Б., см. Сырбу Н. Н. 6, 1067
- Хачатурова С. Б., см. Сырбу Н. Н. 7, 1146
- Херрманн К. Х., см. Гришечкина С. П. 4, 677
- Хмырова И. И., см. Рыжий В. И. 4, 637
- Холплов Х. А., см. Алиев М. И. 11, 2054
- Царенков Б. В., см. Берковиц В. Л. 8, 1406
- Царенков Б. В., см. Вигдорович Е. Н. 8, 1419
- Царенков Б. В., см. Гольдберг Ю. А. 3, 439
- Царенков Б. В., см. Иванов П. А. 11, 1913
- Царенков Г. В., см. Резников Б. И. 11, 1922
- Цацульников А. Ф., см. Аверкиев Н. С. 11, 1967
- Цацульников А. Ф., см. Аверкиев Н. С. 11, 1976
- Цацульников А. Ф., см. Гуткин А. А. 3, 508
- Цветков В. Ф., см. Абдулвагабов М. Ш. 1, 77
- Цветков В. Ф., см. Сафаралиев Г. К. 8, 1437
- Цвстокова Е. В., см. Климакова Н. Н. 3, 558
- Целищев С. Л., см. Вывенко О. Ф. 10, 1745
- Ценелевич С. О., см. Баранов И. А. 1, 73
- Цидильковский И. М., см. Глузман Н. Г. 1, 121
- Цмоць В. М., см. Неймаш В. Б. 11, 1857
- Цмоць В. М., см. Неймаш В. Б. 11, 1864
- Цыбиков Л. В., см. Ройзин Я. О. 3, 422
- Цыпшика Д. И., см. Георгицэ Е. И. 1, 41
- Цыпленков И. Н., см. Кольченко Т. И. 9, 1574
- Цэндин К. Д. Спектры собственных дефектов с отрицательной энергией корреляции в легированных халькогенидных стеклообразных полупроводниках. 4, 617
- Чайка Г. Е., Вавилов С. Е., Панфилова С. В. Неустойчивость сильно легированного полупроводника в условиях джоулева разогрева. 2, 336
- Чайкина Е. И., см. Аверкиев Н. С. 1, 12
- Чалдышев В. В., см. Абрамов В. С. 8, 1355
- Чалдышев В. В., см. Астрова Е. В. 5, 898
- Чалдышев В. В., см. Денисов В. Н. 8, 1472
- Чалый В. П., см. Карнов С. Ю. 8, 1364
- Чапланов А. М., Шибко А. Н., Лазаренко А. В., Чебуков Е. С., Энгелько В. И., Бортнянский А. Л., Клопенков М. Л., Павловец М. В. Влияние электронно-лучевой обработки на контакт титан—кремний. 3, 417
- Чебуков Е. С., см. Чапланов А. М. 3, 417
- Чекурин В. Ф. Пьезорезистивный эффект при динамическом деформировании многодолинных полупроводников. 4, 743
- Челноков В. Е., см. Аникин М. М. 2, 328
- Ченис А., см. Бабьянскэ Э. 5, 823
- Ченис А., см. Бальчионас В. 5, 818
- Чепик Д. И., см. Балтрамюнас Р. 2, 271
- Черенков А. Е., см. Аникин М. М. 3, 479
- Чиркова Е. Г., см. Дружинин Ю. П. 2, 307
- Чернов В. М., см. Мельничук С. В. 5, 876
- Чернов Н. А., см. Астрова Е. В. 5, 898
- Чихрай Е. В., Абдуллин Х. А. К вопросу о повышении разрешающей способности метода нестационарной емкостной спектроскопии глубоких уровней. 4, 751
- Чичерюкии А. В., см. Андреев С. П. 1, 128
- Чудинов С. М., см. Кульбачинский В. А. 12, 2201
- Чукичев М. В., см. Василев В. С. 4, 762
- Чумак В. А., см. Сырбу Н. Н. 7, 1146
- Чунь Гэн, Казначеев В. Ю., Юнович А. Э. Фотолюминесценция сверхрешеток на основе аморфного кремния. 10, 1681
- Чуркин Ю. В., см. Летенко Д. Г. 12, 2132
- Шагимуратов О. Г., см. Дмитриев С. Г. 2, 360
- Шадрин В. Д., см. Серженко Ф. Л. 9, 1579
- Шаймеев С. С., см. Антонова И. В. 5, 847
- Шайович Я. Л., см. Винокуров Д. А. 6, 1022
- Шакин И. А., см. Мудрый А. В. 8, 1459
- Шакмаев А. А., см. Васильев В. А. 10, 1833
- Шамирзаев Т. С., см. Журавлев К. С. 10, 1811
- Шаронова Л. В., см. Макарова Т. Л. 11, 1899
- Шахлевич Л. Н., см. Баранов И. А. 1, 73
- Шаховцев В. И., см. Неймаш В. Б. 11, 1857
- Шаховцев В. И., см. Неймаш В. Б. 11, 1864

- Шаховцова С. И., см. Семенюк Ю. А. 9, 1553
- Шведков И. В., см. Атаев Ж. 8, 1350
- Шевченко Н. В., см. Баранский П. И. 7, 1183
- Шейнкман М. К., см. Бабенцов Б. Н. 7, 1243
- Шейнкман М. К., см. Булах Б. М. 11, 1946
- Шейнкман М. К., см. Гарягдыев Г. 3, 409
- Шейнкман М. К., см. Дроздова И. А. 9, 1629
- Шейнкман М. К., см. Заварицкая Э. И. 7, 1263
- Шек Е. И., см. Выжигин Ю. В. 8, 1324
- Шепкина Р. В., см. Гоголадзе Д. Т. 3, 475
- Шепельский Г. А., см. Гасан-заде С. Г. 5, 871
- Шерстнев В. В., см. Баранов А. Н. 1, 99
- Шерстнев В. В., см. Бреслер М. С. 2, 298
- Шерстнев В. В., см. Воронина Т. И. 2, 276
- Шерстнев В. В., см. Воронина Т. И. 9, 1639
- Шестаков Л. Н., см. Гершензон Е. М. 1, 160
- Шестакова Е. Ф., см. Знаменский Д. А. 12, 2219
- Шеховцов Н. А. Температурная зависимость поглощения излучения миллиметрового диапазона n -германием. 5, 813
- Шибко А. Н., см. Чапланов А. М. 3, 417
- Шик А. Я., см. Бойко И. И. 6, 1094
- Шик А. Я., см. Иванов Ю. Л. 9, 1670
- Шикин В. Б., Шикина Ю. В. Вольтамперная характеристика отдельной заряженной дислокации в полупроводниках. 6, 1065
- Шикин В. Б., Шикина Ю. В. Заряженные дислокации в полупроводниках типа. 12, 2225
- Шикина Ю. В., см. Шикин В. Б. 6, 1065
- Шикина Ю. В., см. Шикин В. Б. 12, 2225
- Шикторов Н., см. Бабянская Э. 5, 823
- Шикторов Н., см. Бальчюнас В. 5, 818
- Шикторов П. Н., см. Гавриленко В. И. 4, 718
- Шикторов П. Н., см. Гавриленко В. И. 8, 1315
- Шиндич В. Л., см. Неймаш В. Б. 11, 1857
- Шиндич В. Л., см. Неймаш В. Б. 11, 1864
- Шкурко А. П., см. Карпов С. Ю. 8, 1361
- Шкут В. А., см. Костылев С. А. 12, 2184
- Шлимак И. С., см. Ионов А. Н. 3, 413
- Шлопак Н. В., см. Абрамов В. В. 3, 513
- Шмавонян Г. Ш., см. Паносян Ж. Р. 6, 1030
- Шмаков С. Л. Расчетные аспекты оптимизации варизонных слоев по выходу люминесценции. 6, 1099
- Шмарцев Ю. В., см. Абрамов В. С. 8, 1355
- Шмарцев Ю. В., см. Астрова Е. В. 5, 898
- Шмарцев Ю. В., см. Воробьева В. В. 10, 1758
- Шмарцев Ю. В., см. Денисов В. Н. 8, 1472
- Шмарцев Ю. В., см. Емцев В. В. 6, 997
- Шмелев Г. М., см. Железняк А. Т. 1, 171
- Шмелев Г. М., см. Эпштейн Э. М. 6, 1098
- Шмидт Б., см. Вербницкая Е. М. 5, 852
- Шофман В. Г., см. Акимов А. В. 4, 713
- Шофман В. Г., см. Акимов А. В. 7, 1133
- Шофман В. Г., см. Акимов А. В. 9, 1593
- Штельмах К. Ф., см. Мастеров В. Ф. 8, 1375
- Штым В. С., см. Неймаш В. Б. 11, 1864
- Шульга Е. П., см. Дроздова И. А. 9, 1629
- Шульга М. И., см. Гольдберг Ю. А. 3, 439
- Шульга М. И., см. Джаманбалин К. К. 10, 1774
- Шустров В. А., см. Бахадырханов М. К. 11, 1952
- Щедрин А. И., см. Каплан Б. И. 11, 2011
- Щербаченко Т. М., см. Гафийчук В. В. 10, 1696
- Эльтазаров Б. Т., см. Знаменский Д. А. 12, 2219
- Энгелько В. И., см. Чапланов А. М. 3, 417
- Эпштейн Э. М. Планарный эффект Холла в полупроводниковой сверхрешетке. 2, 354
- Эпштейн Э. М., Шмелев Г. М., Железняк А. Т. Поле неидеального δ -легированного слоя в условиях пробоя экранирования. 6, 1098
- Эфрос Ал. Л., см. Кохановский С. И. 3, 493
- Юлдашев Ш. У., см. Георгицэ Е. И. 11, 1960
- Юлдашев Ш. У., см. Георгицэ Е. И. 11, 2024
- Юнович А. Э., см. Чунь Гэн. 10, 1681
- Юрийчук И. Н., см. Мельничук С. В. 5, 876
- Юрова Е. С., Картавых А. В. Оптимальные параметры ЭС твердого раствора $\text{GaAs}_{1-x}\text{P}_x$ для изготовления датчиков давления. 10, 1827
- Юрченко В. В., см. Гуревич Ю. Г. 12, 2109
- Юрьев В. А., см. Калинушкин В. П. 5, 798
- Юсупов Р. Г., см. Знаменский Д. А. 12, 2219
- Юсупова Ш. А., см. Абдурахманов К. П. 6, 1075
- Юшка Г., см. Голикова О. А. 3, 551

- Явич Б. С., см. Винокурова Д. А. 6, 1022
- Язева Т. В., см. Кохановский С. И. 3, 493
- Якименко А. Н. Механизм генерации заряда в МДП структурах через поверхностные состояния. 11, 2050
- Яковлев Ю. П., см. Андаспаева А. А. 3, 394
- Яковлев Ю. П., см. Андреев И. А. 8, 1429
- Яковлев Ю. П., см. Бреслер М. С. 2, 298
- Яковлев Ю. П., см. Воронина Т. И. 2, 276
- Яковлев Ю. П., см. Воронина Т. И. 2, 283
- Яковлев Ю. П., см. Воронина Т. И. 9, 1639
- Яржембицкий В. Б., см. Андерсен Г. Ю. 11, 1999
- Ярошецкий И. Д., см. Бланк А. Ю. 1, 67
- Яссиевич И. Н., см. Абакумов В. Н. 9, 1489
- Яссиевич И. Н., см. Бреслер М. С. 2, 298
- Ястребов С. Г., см. Андаспаева А. А. 3, 394
- Ясутис В., см. Бабянскас Э. 5, 823
- Ятлинко И. И., см. Голикова О. А. 1, 170
- Яфясов А. М., Божевольнов В. Б., Перепелкин А. Д. Электрофизические свойства слоистой структуры на основе (CdHg)Te в системе полупроводник—электролит. 8, 1339
- Яфясов А. М., Перепелкин А. Д. Исследование скоростей заполнения квантовых подзон ОПЗ узкощелевых полупроводников (CdHg)Te. 4, 748
- Яфясов А. М., см. Перепелкин А. Д. 1, 156